

บทที่ 4

ผลการทดลองและบทวิจารณ์

4.1 ผลการวิเคราะห์วัตถุสืบ

4.1.1. ความชื้น (moisture) ผลการวิเคราะห์ความชื้นของแกลบทั้ง 3 แหล่ง แสดงในตารางที่ 4.1 พบว่า เปอร์เซ็นต์ความชื้นของแกลบทั้ง 3 แหล่ง มีความใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 7.8 - 8.0 % ปริมาณความชื้นจะมีอิทธิพลต่อปริมาณแฉะแกลบที่ผลิตได้ ถ้าแกลบมีปริมาณความชื้นสูงเกินไป จะทำให้ต้องใช้พลังงานในการเผาสูง และได้ yield ต่ำ แต่ปริมาณที่พบในการวิจัยนี้ นับว่าเป็นแกลบที่มีความชื้นต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีผู้ทำมาแล้ว ในรายงาน International Research and Development Cooperation ITIT Project No. 83-1-8, october 1986 ซึ่งพบว่า ความชื้นของแกลบในประเทศไทย อยู่ในช่วง 8.12 - 11.54% ดังนั้น แกลบที่ใช้ จึงเหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบเริ่มต้น

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในแกลบจากแหล่งต่างๆ

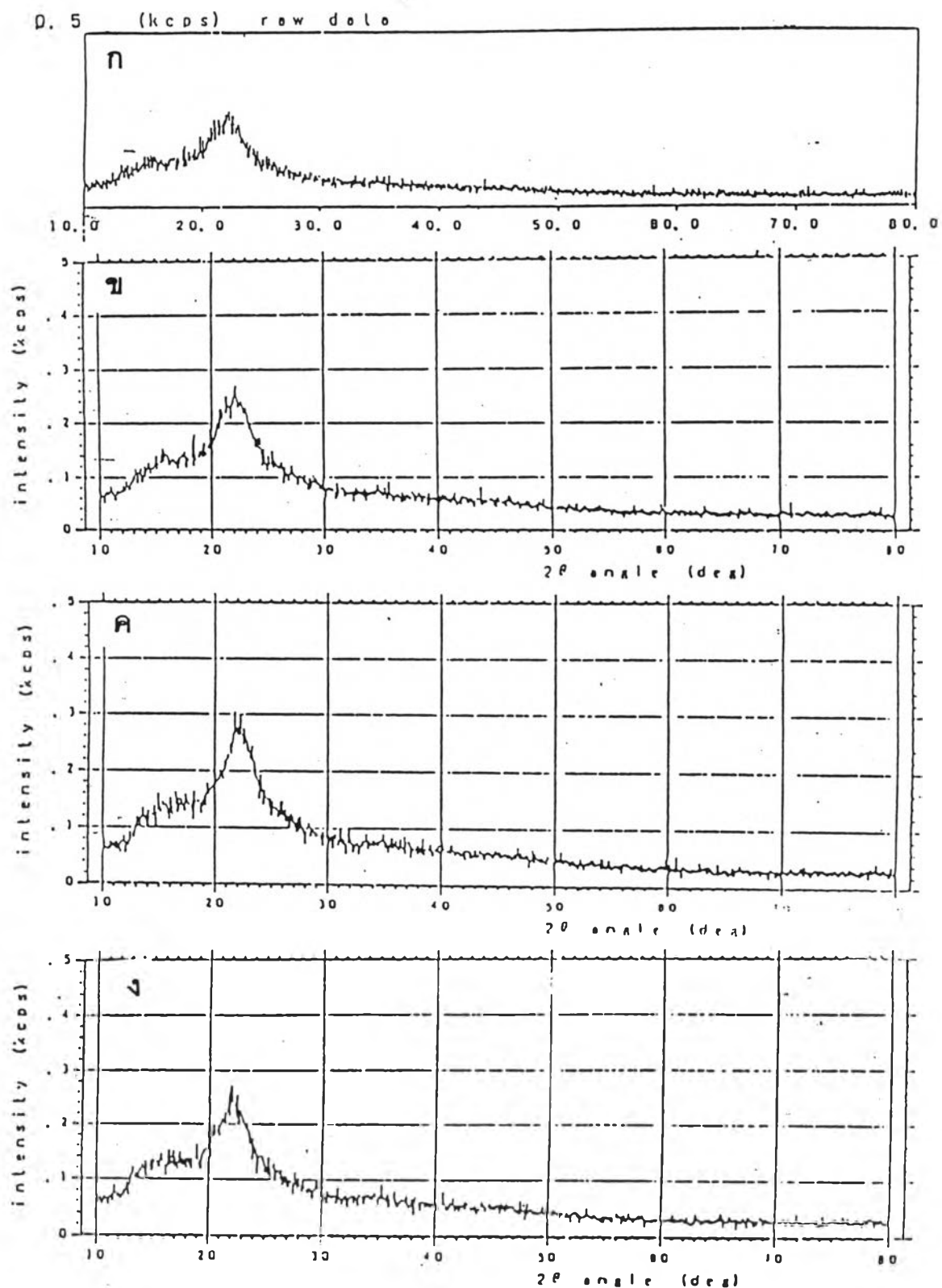
ตัวอย่างที่	แหล่งที่มา	ปริมาณความชื้น (%)
1	พิจิตร , R ₁	8.0
2	นครราชสีมา , R ₂	7.8
3	ชัยภูมิ , R ₃	7.8

4.1.2. การศึกษาโครงสร้างผลึก โครงสร้างผลึกของแกลบทั้ง 3 แหล่ง ศึกษาโดยใช้เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟร็กโตมิเตอร์ ผลิตโดยบริษัท Phillips Model PW 1130 / 90 ดังแสดงในรูปที่ 4.1 พบว่าไม่ปรากฏ XRD peak ที่ชัดเจนมีเพียง board peak ที่ $2\theta = 22^\circ$ ซึ่งเมื่อนำผลที่ได้

เปรียบเทียบกับ standard ASTM แล้ว พบว่าเป็นลักษณะ XRD - Pattern ของซิลิกาอสัณฐาน การที่ SiO_2 ในแอลบอยู่ในรูปที่เป็นอสัณฐาน ทำให้มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์ เนื่องจากมีพลังงานอิสระ (free energy) ต่ำกว่า SiO_2 ที่อยู่ในรูปผลึก ซึ่งคำนวณทางเทอร์โมไดนามิก จากการศึกษาของ J.G Lee and I.B Cutler (1975) จึงทำให้ปฏิกิริยาการเกิดซิลิกอนคาร์ไบด์ เป็นไปได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าปฏิกิริยาการเกิดซิลิกอนคาร์ไบด์จากควออตซ์ และกราไฟต์ ดังนั้นแอลบที่เลือกมาใช้ในการวิจัยนี้ จึงควรเป็นแอลบที่มีความเหมาะสมในการผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์

4.1.3. การศึกษาจุลโครงสร้างและองค์ประกอบ ศึกษาลักษณะจุลโครงสร้างของแอลบสค โดยใช้เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ผลิตโดยบริษัท Jeol Model T330A ดังรูปที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงลักษณะผิวนอก (Outer epidermis) ของแอลบ พบเกรน (grain) เล็กๆ ของ SiO_2 กระจายตัวอยู่ทั่วไปบนผิวซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาโดย Si-KCl Mapping ดังรูปที่ 4.3 และสอดคล้องกับผลงานของ Sharma et al. (1984) ที่พบว่า SiO_2 ในแอลบจะอยู่ในรูปของอนุภาคเล็กๆ ที่กระจายฝังตัวอยู่ทั่วไปบนผิวของ matrix ของสารอินทรีย์

4.1.4 ผลการศึกษารายละเอียดองค์ประกอบของแอลบโดยเครื่อง Energy Dispersive X-ray analysis (EDX) แสดงในตารางที่ 4.2 จะเห็นว่าองค์ประกอบหลักคือ Si และมีสิ่งเจือปนอื่นเพียงเล็กน้อย ได้แก่ Mg, Al, Na Fe และ Ca เป็นต้น จะเห็นว่าการวิเคราะห์โดย EDX ไม่แสดงองค์ประกอบที่เป็นคาร์บอน เนื่องจากคาร์บอนเป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบา ไม่สามารถตรวจสอบด้วยเครื่อง EDX ได้ แต่เมื่อศึกษาโดยใช้ Wavelength Dispersive X-ray analysis (WDX) ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ก็พบพีคของคาร์บอนที่ชัดเจน แสดงว่ามีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักอีกธาตุหนึ่งอยู่ด้วย

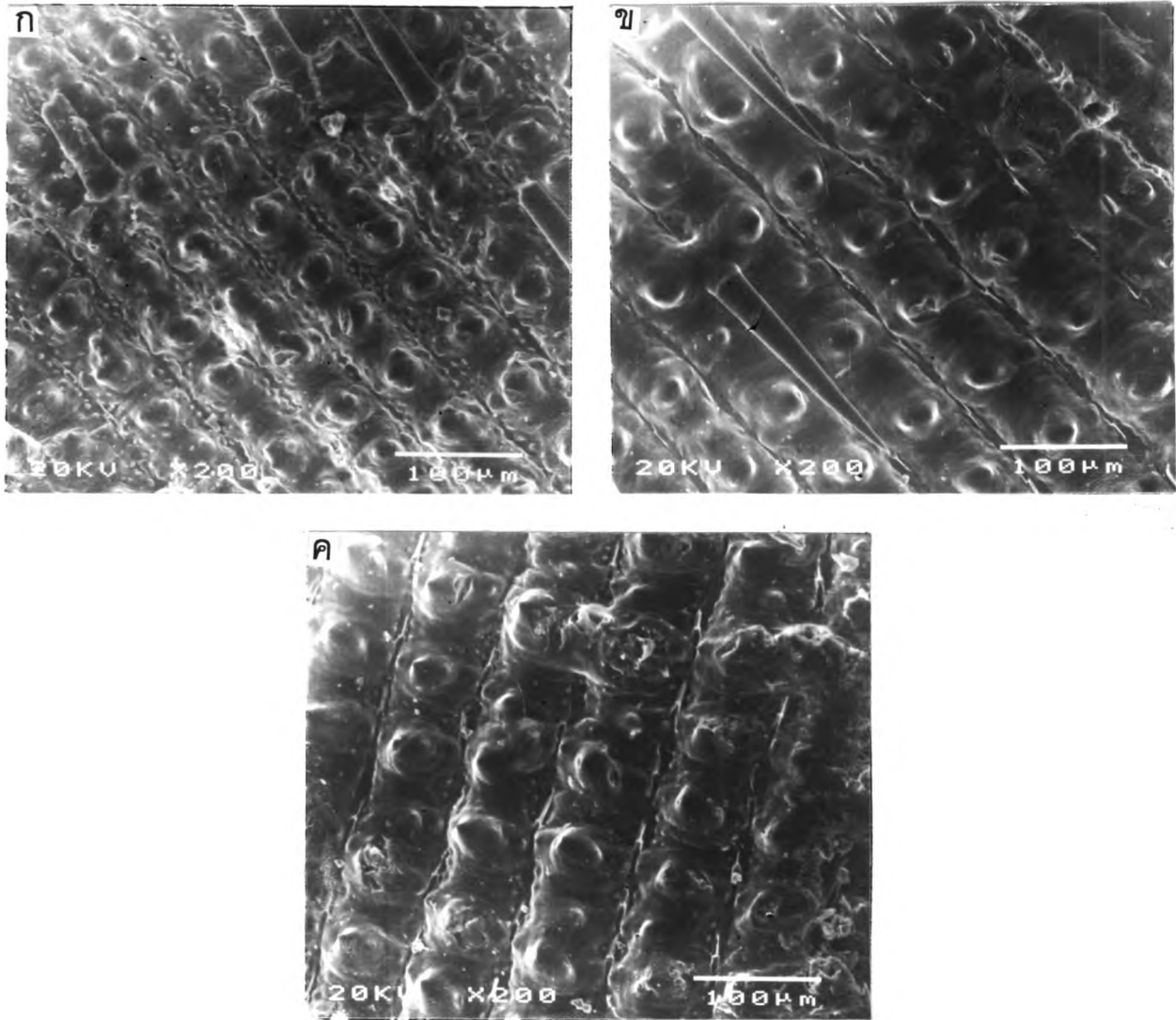


รูปที่ 4.1 X - ray diffraction pattern ของแกลบ

ก) standard peak ของซิลิกาอสังฐาน ASTM no 11-695 ค) แกลบจากจังหวัดนครราชสีมา (R₂)

ข) แกลบจากจังหวัดพิจิตร (R₁)

ง) แกลบจากจังหวัดชัยภูมิ (R₃)

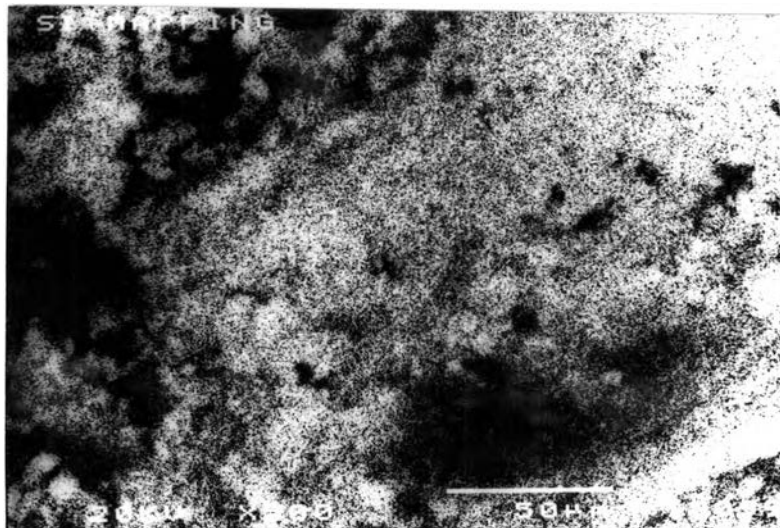


รูปที่ 4.2 จุดโครงสร้างของแกลบลด

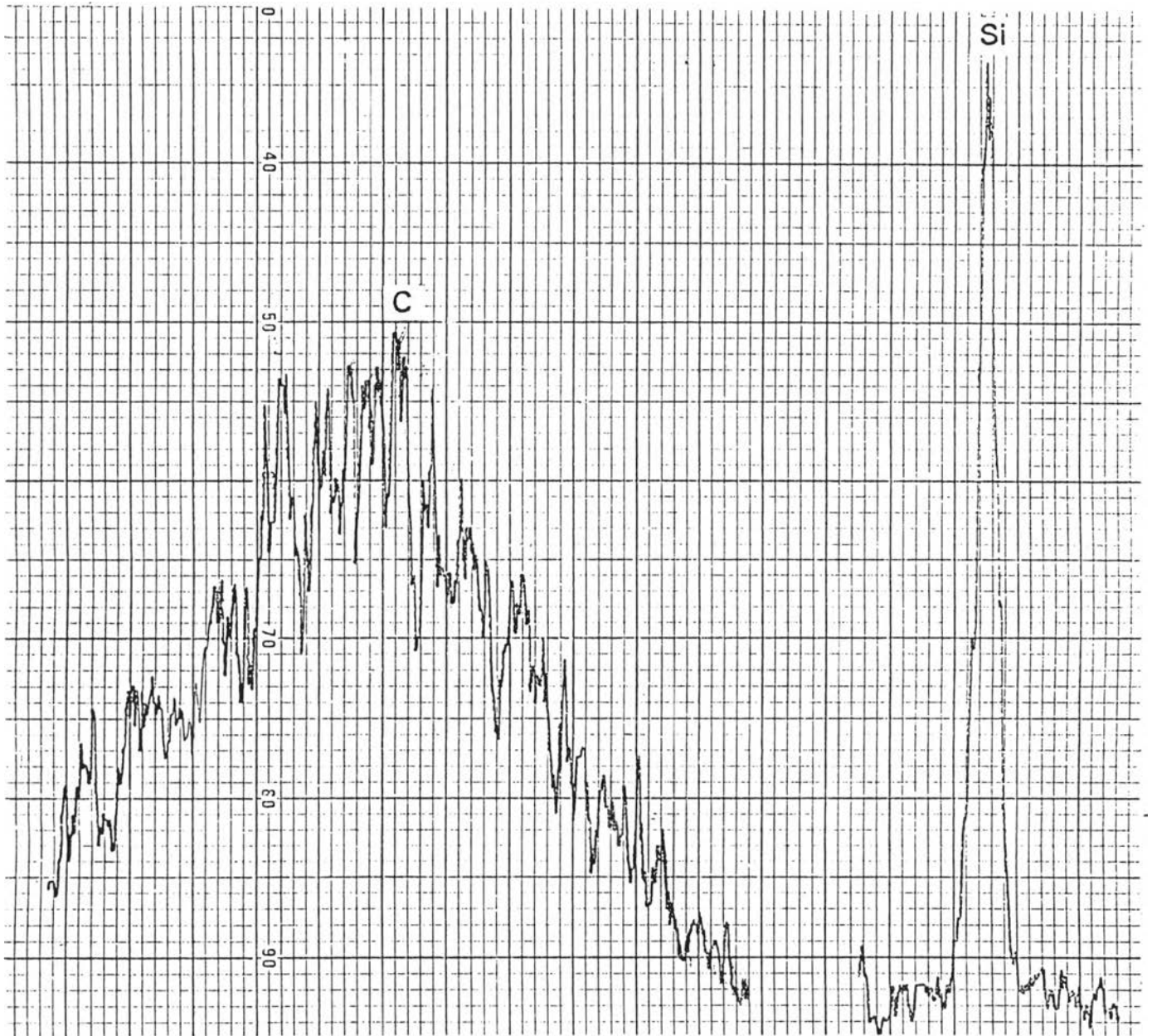
ก) แกลบลจากจังหวัดพิจิตร

ข) แกลบลจากจังหวัดนครราชสีมา

ค) แกลบลจากจังหวัดชัยภูมิ



รูปที่ 4.3 Si-KOx mapping ของแกส



รูปที่ 4.4 WDX peak ของคาร์บอนในแก๊สสด

ตารางที่ 4.2 แสดงธาตุองค์ประกอบของแม่เหล็ก R₁ , R₂ , R₃

ตัวอย่าง	ธาตุองค์ประกอบ	wt%
R ₁	Si	93.68
	Mg	0.23
	Al	5.19
	Ti	0.14
	Na	0.71
R ₂	Si	87.76
	Mg	0.46
	Al	9.58
	Na	0.86
	Fe	0.48
	Ca	0.86
R ₃	Si	93.57
	Mg	0.22
	Al	4.05
	Na	0.63
	Fe	0.51
	Ca	0.15
	K	0.42
	Mn	0.46

4.2 ผลการวิเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตได้จากแกลบ

4.2.1. การศึกษาโครงสร้างผลึก โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน เพื่อศึกษารูปผลึก และชนิดของสารประกอบที่ผลิตได้

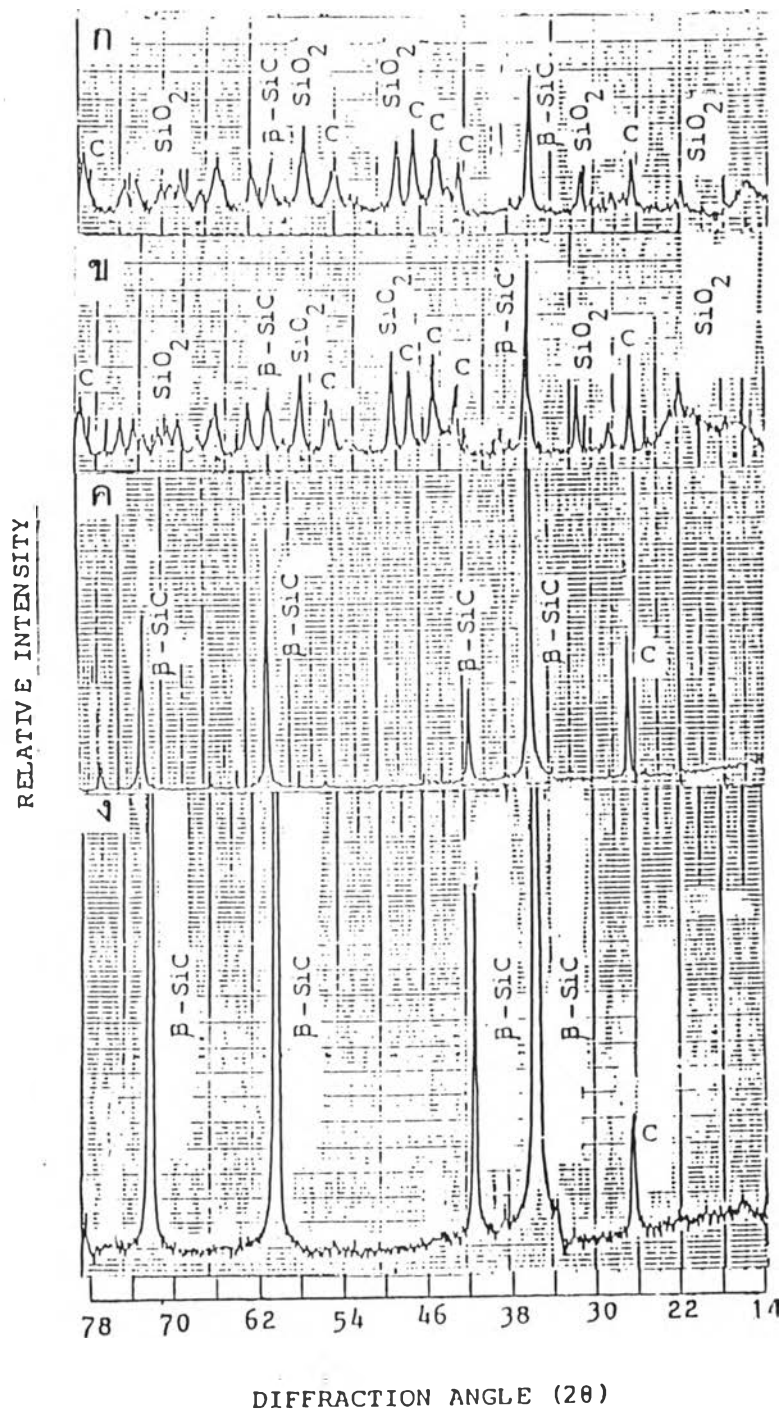
เมื่อนำแกลบจากทั้ง 3 แหล่ง มาทำปฏิกิริยาไพโรไลซิส ที่อุณหภูมิต่างๆ คือ 1310, 1410, 1550 และ 1750°C แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์โครงสร้าง โดยเทคนิค X-ray diffractometry ได้ผลดัง X-ray diffraction pattern ในรูปที่ 4.5 - 4.10 ซึ่งพบว่าการเผาแกลบ RHA₁, RHA₂ และ RHA₃ พีคที่ $2\theta = 35.5^\circ, 59.9^\circ, 72.08^\circ$ และ 41.3° ดังรูปที่ 4.5, 4.7 และ 4.9 ซึ่งสอดคล้องกับพีคของ β -SiC ตาม ASTM No. 29 - 1129 เป็นสารที่มีลักษณะโครงสร้างของคิวบิก XRD pattern ของ β -SiC นี้ เริ่มปรากฏที่อุณหภูมิ 1310°C ดังรูป แต่ที่อุณหภูมินี้พีคของ SiC ที่ได้มี intensity ต่ำ แสดงว่าเป็นอุณหภูมิที่ยังต่ำไปสำหรับการเกิดปฏิกิริยาตามสมการที่ 1 นอกจากนี้ มีพีคของสารชนิดอื่นประปรายอยู่ เช่น พีคที่ $2\theta = 22^\circ$ ซึ่งตรงกับพีคของผลึกซิลิกาซึ่งบางส่วนได้เปลี่ยนรูปจากออสตรูานเป็นคริสโตบาไลต์ (cristobalite) เนื่องจากการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ James and Rao (1986) รายงานว่าการเกิดผลึก (crystallization) ของ SiO₂ ในแกลบ จะพบเมื่อเผาแกลบที่อุณหภูมิสูงกว่า 700°C ส่วนพีคอื่นๆ ที่ปรากฏเป็นพีคของซิลิกาและคาร์บอนที่เหลือจากปฏิกิริยา สำหรับสารที่ผ่านการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 1410°C ยังแสดงลักษณะ XRD - pattern ที่คล้ายคลึงกันกับการเผาที่อุณหภูมิ 1310°C แสดงว่าที่อุณหภูมิทั้งสองปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นยังไม่สมบูรณ์ และเมื่อใช้อุณหภูมิในการเผาสูงจาก 1550 - 1750°C พีคทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นพีคของเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ ดังรูปที่ 4.5 (ง) ไม่ปรากฏพีคของซิลิกา มีเพียงพีคที่มี intensity ต่ำ ที่ $2\theta = 26^\circ$ ซึ่งเป็นพีคของคาร์บอนที่เหลือจากปฏิกิริยา (residual carbon) แสดงว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และมีคาร์บอนอยู่ในส่วนผสมมากเกินพอ ผลที่ได้จากการทดลองนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Raghavarapu Venkata Krishnarao et. al (1991) ที่พบว่าอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิสของแกลบ คือ อุณหภูมิมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากซิลิกาออสตรูานเป็นผลึก เกิดผลึกซิลิกอนคาร์ไบด์ หรือเกิดเป็นกราไฟต์ และในการทดลองนี้ ก็พบการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยเฉพาะปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาไพโรไลซิส แต่ในช่วง 1550 - 1750°C จะไม่เห็นความแตกต่างที่เด่นชัดของ XRD - pattern แสดงว่าในช่วงอุณหภูมิ

ดังกล่าว การเกิดปฏิกิริยาเป็นไปอย่างสมบูรณ์และได้สารซิลิกอนคาร์ไบด์ ส่วนจะอยู่ในรูปของวิสเกอร์หรือโพลีคริสตัลไลน์ จะต้องศึกษาจุลโครงสร้างประกอบต่อไป อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าผลที่ได้จากการเผาถ่านแกลบทั้ง 3 แหล่ง ไม่มีความแตกต่างกันที่เด่นชัด

สำหรับซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากถ่านแกลบ (RHC) ทั้ง 3 แหล่ง ดังรูปที่ 4.6, 4.8 และ 4.10 นั้นพบว่า XRD - pattern ที่ได้จากการเผาไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 1310°C แสดงลักษณะ broad peak ของซิลิกาเป็นหลัก ส่วนพีคของซิลิกอนคาร์ไบด์ปรากฏขึ้นไม่ชัดเจน เป็นพีคที่มี intensity ต่ำมาก ส่วน XRD - pattern ของผลิตภัณฑ์เผาที่อุณหภูมิ 1410°C เริ่มปรากฏพีคของซิลิกอนคาร์ไบด์ชัดเจนขึ้น แต่ก็ยังมี intensity ต่ำมากเช่นกัน นอกจากนี้ จะเห็นว่าซิลิกาที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปของซิลิกาอสัณฐานตามลักษณะของ XRD - broad peak ที่ $2\theta = 22^{\circ}$ แต่ที่อุณหภูมิระหว่าง $1550 - 1750^{\circ}\text{C}$ พีคของเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ปรากฏชัดเจน แสดงว่าในช่วงอุณหภูมินี้เหมาะสม สำหรับการเกิดปฏิกิริยาตามสมการที่ 1 นอกจากพีคของซิลิกอนคาร์ไบด์ ก็จะมีพีคของคาร์บอนปรากฏอยู่ แสดงว่ามีคาร์บอนเหลือจากปฏิกิริยา เช่นเดียวกับการเผาถ่านแกลบ เมื่อเปรียบเทียบผลการเผาถ่านแกลบและถ่านแกลบ จะเห็นว่าปฏิกิริยาการเกิดซิลิกอนคาร์ไบด์จากถ่านแกลบนั้น เริ่มเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่าการใช้ถ่านแกลบ ซึ่งอาจเกิดเนื่องมาจาก โครงสร้างของซิลิกาและคาร์บอน รวมทั้งขนาดอนุภาคของสารทั้งสองในถ่านแกลบและถ่านแกลบ มีความแตกต่างกัน ดังรายงานการวิจัยของ Raghavarapu Venkata Krishnarao et. al (1991) พบว่า การเกิดซิลิกอนคาร์ไบด์จากถ่าน มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ

1. ลักษณะสารเริ่มต้น คือ ลักษณะโครงสร้างของสารซิลิกาและคาร์บอน
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของซิลิกอนมอนอกไซด์ (SiO) (ปฏิกิริยาที่ 2)
3. สภาวะที่ใช้ในกระบวนการไพโรไลซิส

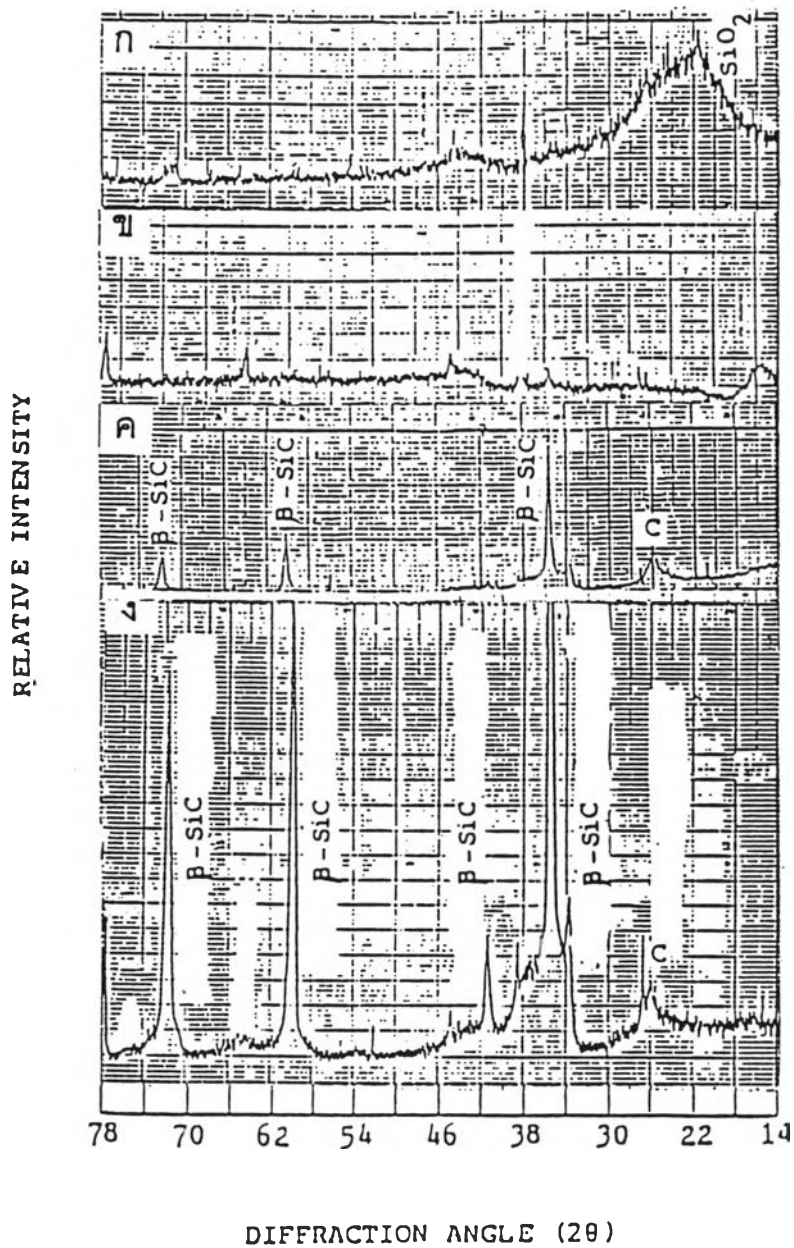
สำหรับในการทดลองนี้ สภาวะที่ใช้ในกระบวนการเผาไพโรไลซิส ทั้ง ถ่านแกลบและถ่านแกลบนั้น ใช้สภาวะเดียวกัน แต่สารเริ่มต้นนั้นต่างกัน คือ ถ่านแกลบที่ได้มีเพียงซิลิกาเป็นสารหลัก และต้องเติมผงคาร์บอน เพื่อเป็นแหล่งของคาร์บอน ส่วนถ่านแกลบนั้นมีทั้งซิลิกาและคาร์บอนที่มาจากถ่านแกลบเพียงอย่างเดียว ซึ่งลักษณะโครงสร้างของคาร์บอนจากแหล่งทั้งสองจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ กระบวนการเผาถ่านแกลบและถ่านแกลบ ใช้สภาวะที่แตกต่างกัน ดังนั้นลักษณะโครงสร้างของซิลิกาเอง ก็อาจจะมี ความแตกต่างกันด้วย



รูปที่ 4.5 XRD pattern ของ RHA₁ หลังปฏิกิริยาไพโรไลซิส

- ก). ที่อุณหภูมิ 1,310 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ข). ที่อุณหภูมิ 1,410 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ค). ที่อุณหภูมิ 1,550 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ง). ที่อุณหภูมิ 1,750 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที

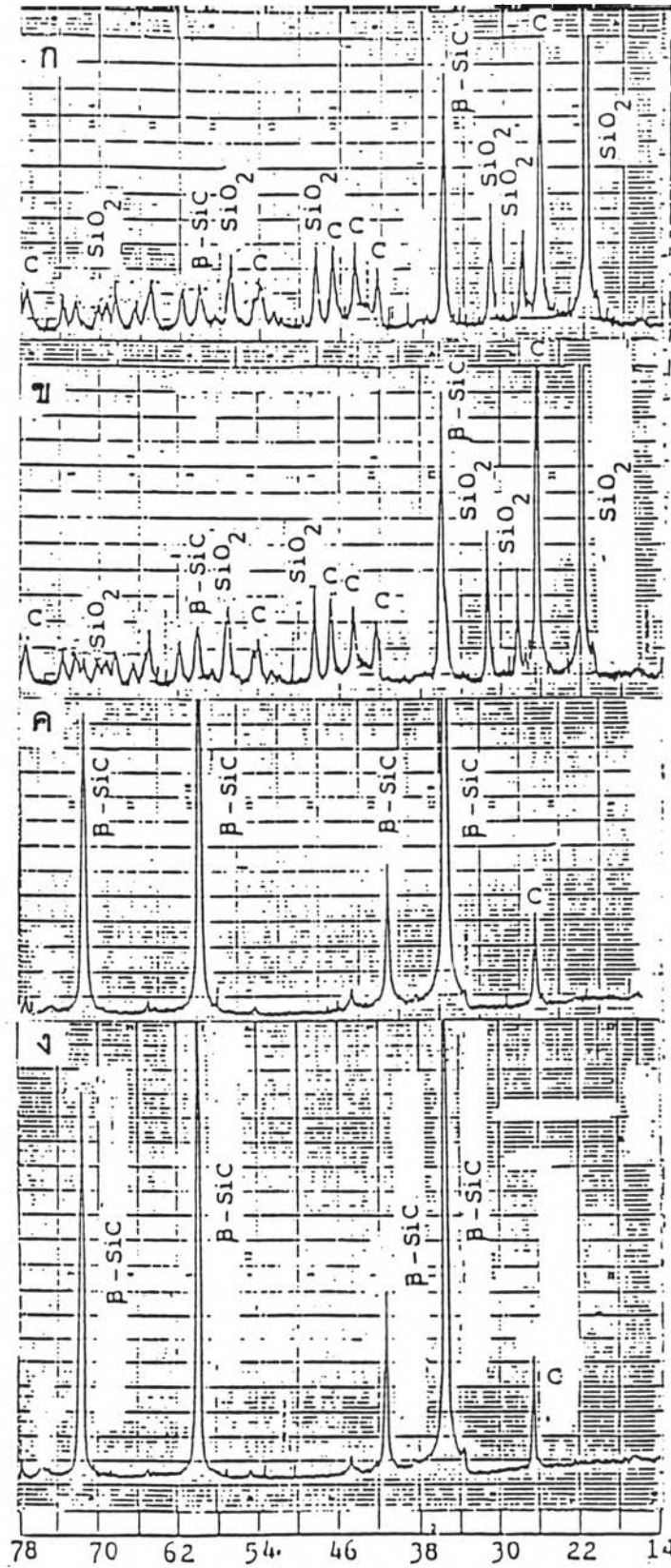
ต้นฉบับ หน้าขาดหาย



รูปที่ 4.6 XRD pattern ของ RHC₁ หลังปฏิกิริยาไพโรไลซิส

- ก). ที่อุณหภูมิ 1,310 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
- ข). ที่อุณหภูมิ 1,410 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
- ค). ที่อุณหภูมิ 1,550 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
- ง). ที่อุณหภูมิ 1,750 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที

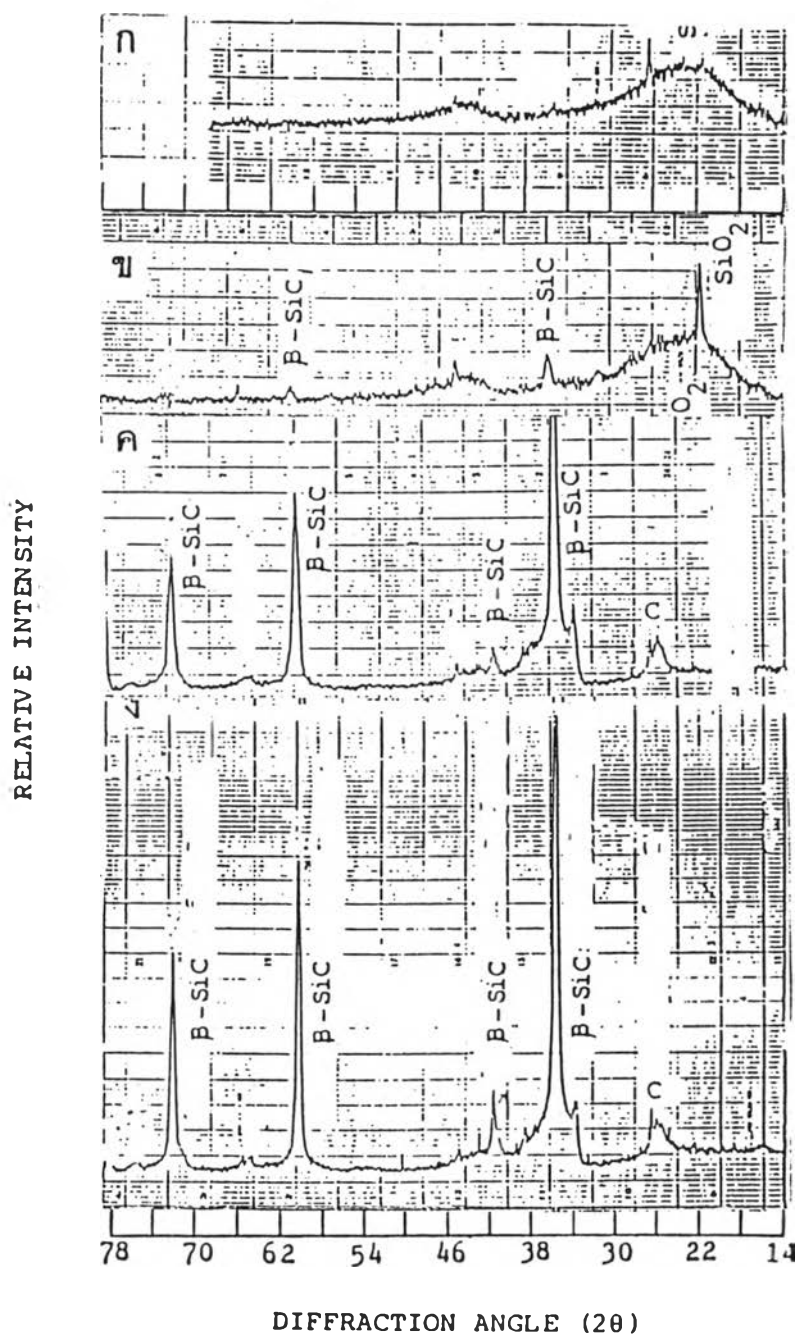
RELATIVE INTENSITY



DIFFRACTION ANGLE (2θ)

รูปที่ 4.7 XRD pattern ของ RHA₂ หลังปฏิกิริยาไพโรไลซิส

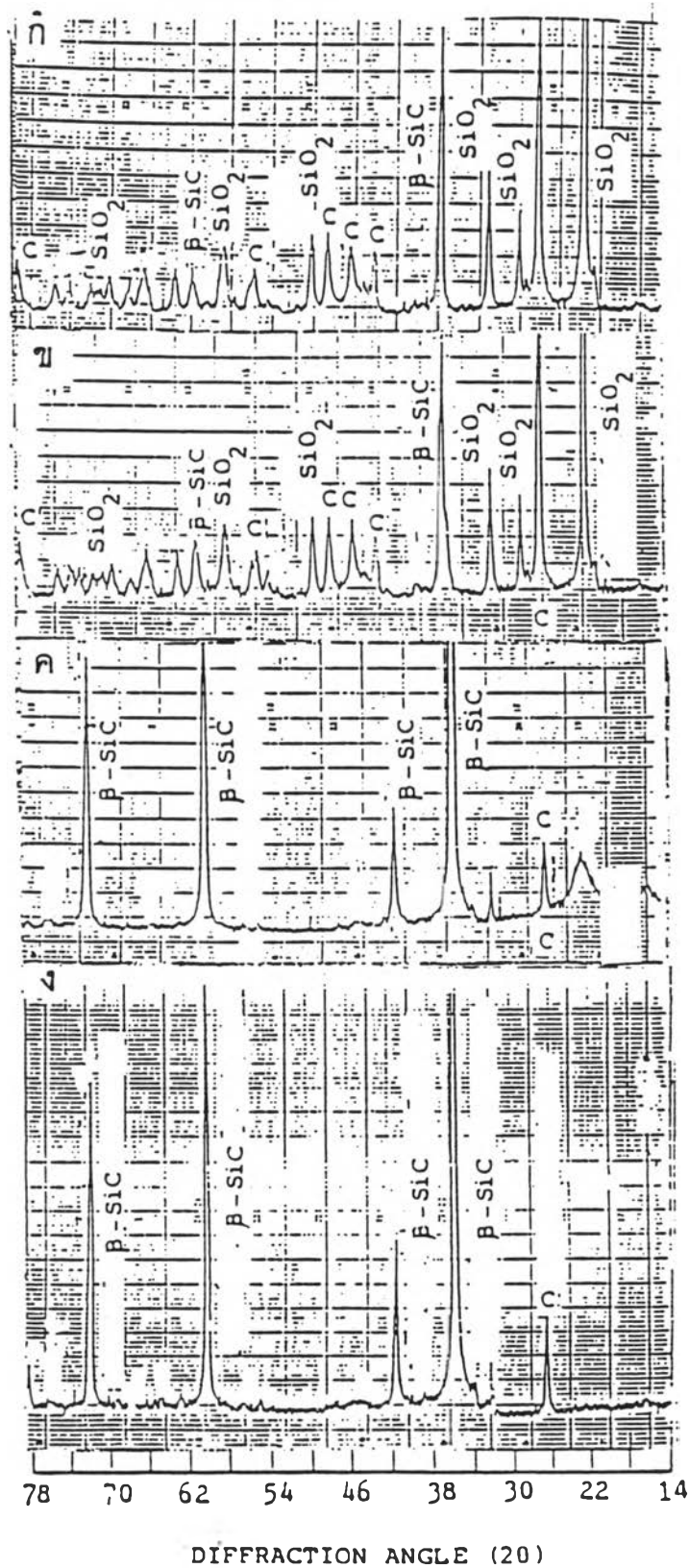
- ก). ที่อุณหภูมิ 1,310 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
- ข). ที่อุณหภูมิ 1,410 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
- ค). ที่อุณหภูมิ 1,550 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
- ง). ที่อุณหภูมิ 1,750 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที



รูปที่ 4.8 XRD pattern ของ RHC₂ หลังปฏิกิริยาไพโรไลซิส

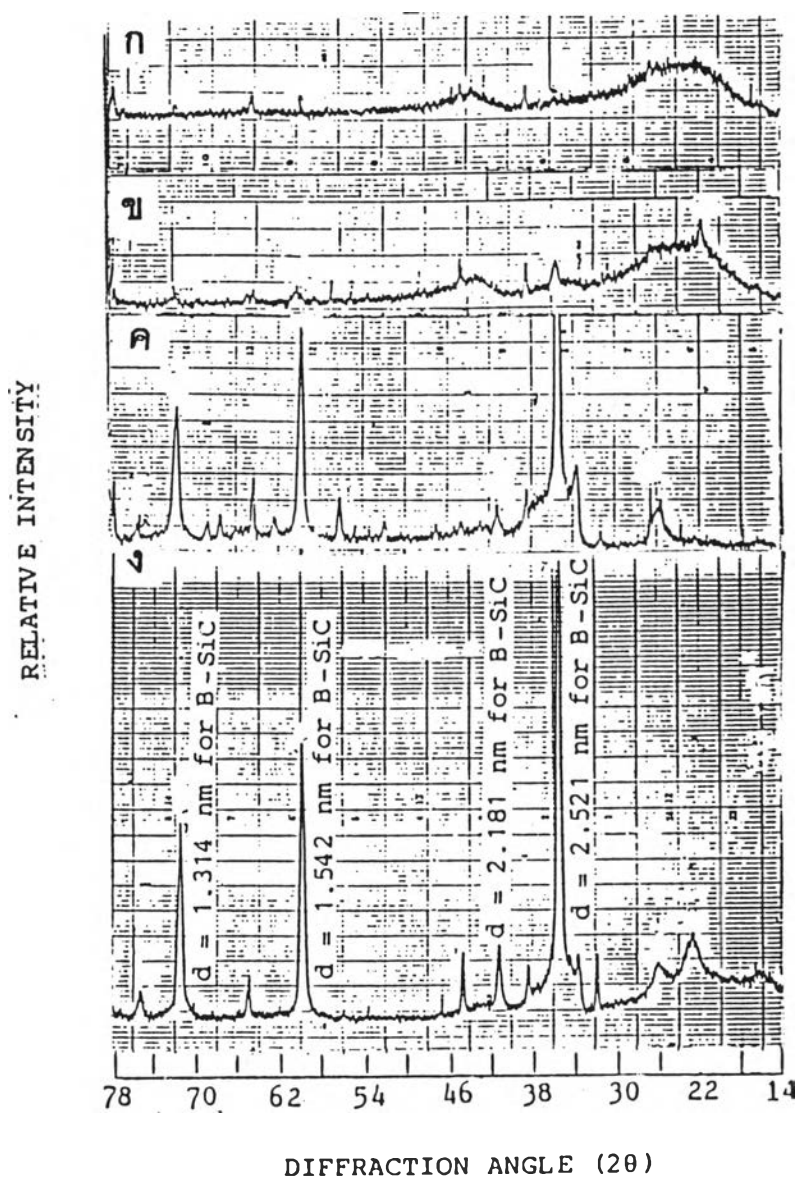
- ก). ที่อุณหภูมิ 1,310 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ข). ที่อุณหภูมิ 1,410 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ค). ที่อุณหภูมิ 1,550 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ง). ที่อุณหภูมิ 1,750 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที

RELATIVE INTENSITY



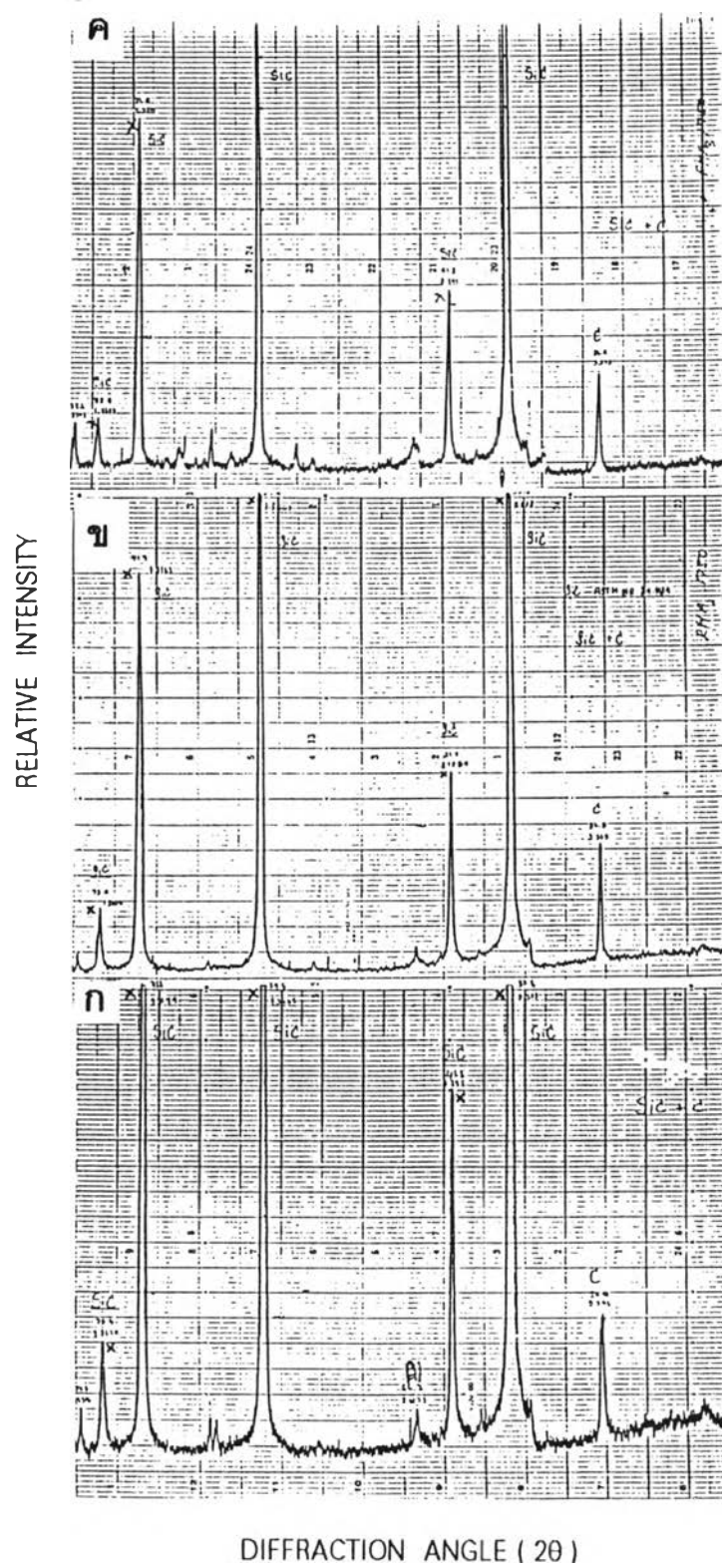
รูปที่ 4.9 XRD pattern ของ RHA₃ หลังปฏิกิริยาไพโรไลซิส

- ก). ที่อุณหภูมิ 1,310 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ข). ที่อุณหภูมิ 1,410 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ค). ที่อุณหภูมิ 1,550 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ง). ที่อุณหภูมิ 1,750 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที

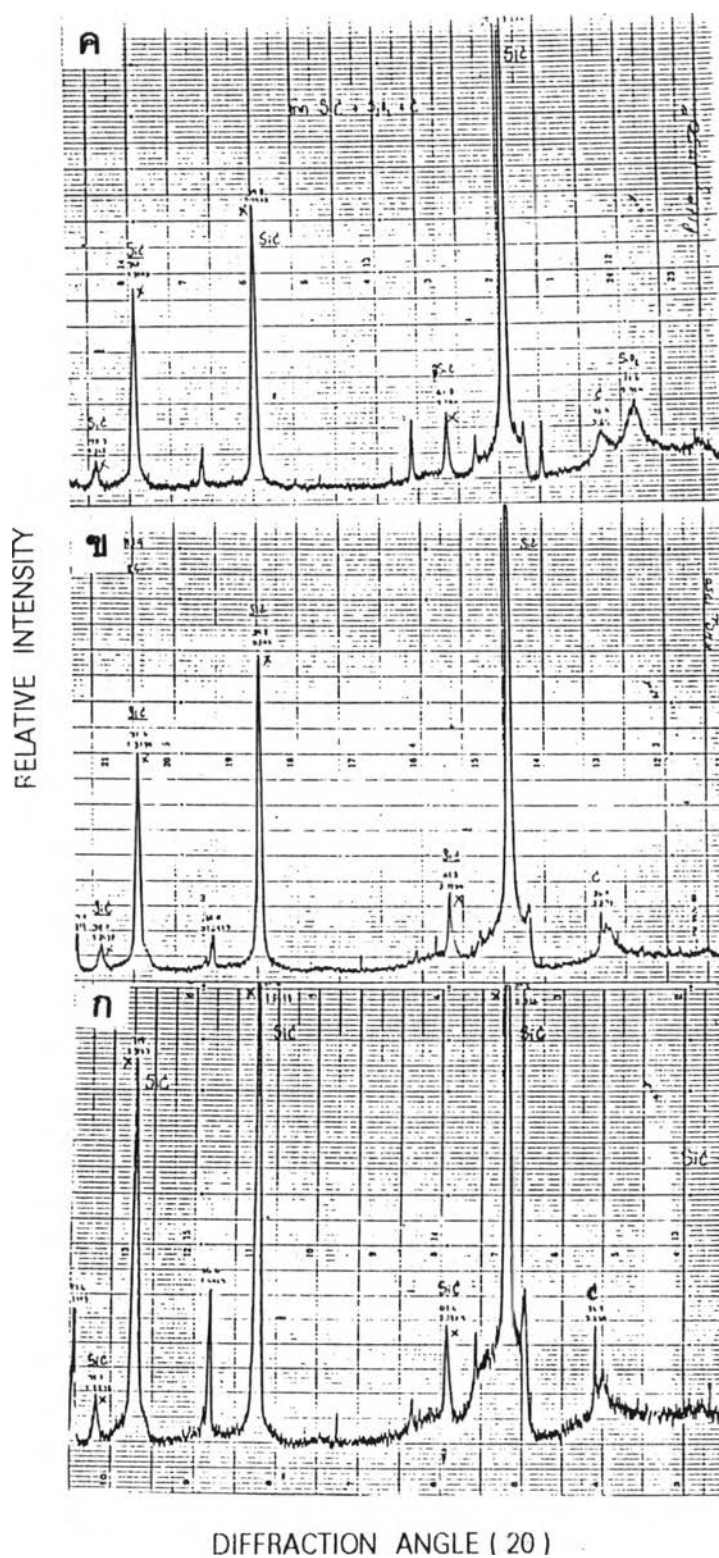


รูปที่ 4.10 XRD pattern ของ RHC₃ หลังปฏิกิริยาไพโรไลซิส

- ก). ที่อุณหภูมิ 1,310 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ข). ที่อุณหภูมิ 1,410 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ค). ที่อุณหภูมิ 1,550 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที
 ง). ที่อุณหภูมิ 1,750 °C , 1 ชั่วโมง, อัตราการให้ความร้อน 50°C/นาที



รูปที่ 4.11 XRD pattern เปรียบเทียบการเกิดสารซิลิกอนคาร์ไบด์ จาก RHA₁, RHA₂, และ RHA₃



รูปที่ 4.12 XRD pattern เปรียบเทียบการเกิดสารซิลิกอนคาร์ไบด์ จาก RHC₁, RHC₂, และ RHC₃

ข. การวิเคราะห์ทางเคมี

ตารางที่ 4.3 แสดงปริมาณ SiC ที่เกิดขึ้น และปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากปฏิกิริยาของ
แบบ R₁

อุณหภูมิไพโรไลซิส (°C)	RHA ₁		RHC ₁	
	%SiC	%C	%SiC	%C
1,310	62.40	37.60	56.67	43.33
1,410	62.33	36.67	57.00	43.00
1,550	88.11	11.89	65.71	34.29
1,750	89.76	10.24	68.89	31.11

ตารางที่ 4.4 แสดงปริมาณ SiC ที่เกิดขึ้น และปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากปฏิกิริยาของ
แบบ R₂ .

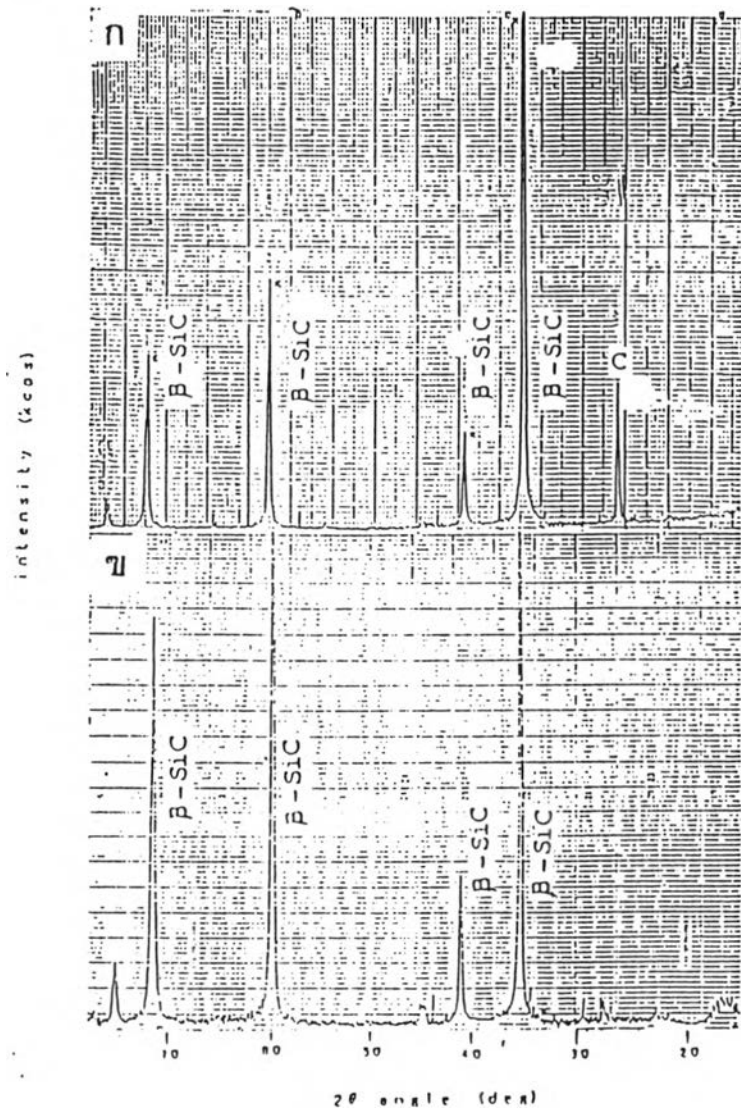
อุณหภูมิไพโรไลซิส (°C)	RHA ₁		RHC ₂	
	%SiC	%C	%SiC	%C
1,310	63.33	36.67	54.00	46.00
1,410	64.29	35.71	55.00	45.00
1,550	87.50	12.50	66.67	33.33
1,750	88.00	12.00	70.00	30.00

ตารางที่ 4.5 แสดงปริมาณ SiC ที่เกิดขึ้น และปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากปฏิกิริยาของ
 แกลบ R₃

อุณหภูมิโพโรไลซิส (°C)	RHA ₃		RHC ₃	
	%SiC	%C	%SiC	%C
1,310	61.67	38.33	52.94	47.06
1,410	63.48	36.52	53.00	47.00
1,550	86.36	13.64	66.67	33.33
1,750	87.27	12.73	67.50	32.50

จะเห็นว่าหลังจากเกิดปฏิกิริยาไปเป็นซิลิกอนคาร์ไบด์แล้วยังมีคาร์บอนเหลืออยู่ ซึ่งคาร์บอนนี้สามารถถูกกำจัดออกไปได้ โดยการนำเอาสารซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้หลังจากผ่าน Hot Press มาเผาที่อุณหภูมิ 700° เป็นเวลา 3 ชม. ในบรรยากาศปกติ

เมื่อนำสารซิลิกอนคาร์ไบด์หลังจากได้คาร์บอนแล้ว ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันจะไม่พบพีคที่ $2\theta \approx 26^\circ$ ซึ่งเป็นพีคของคาร์บอนอยู่เลยซึ่งแสดงให้เห็นดังรูปที่ 4.13 เป็นการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันของสารซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้หลังจากการเผาด้วย Hot Press และหลังจากเผาได้คาร์บอนแล้วที่อุณหภูมิ 1550°C ในทำนองเดียวกันสำหรับตัวอย่างอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน



รูปที่ 4.13 XRD pattern ของซิลิกอนคาร์ไบด์

ก) ก่อนเผาไล่คาร์บอน

ข) หลังเผาไล่คาร์บอน

4.2.3. การศึกษาลักษณะจุลโครงสร้าง โดยใช้เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ผลการวิเคราะห์ แสดงดังรูปที่ 4.14 - 4.19

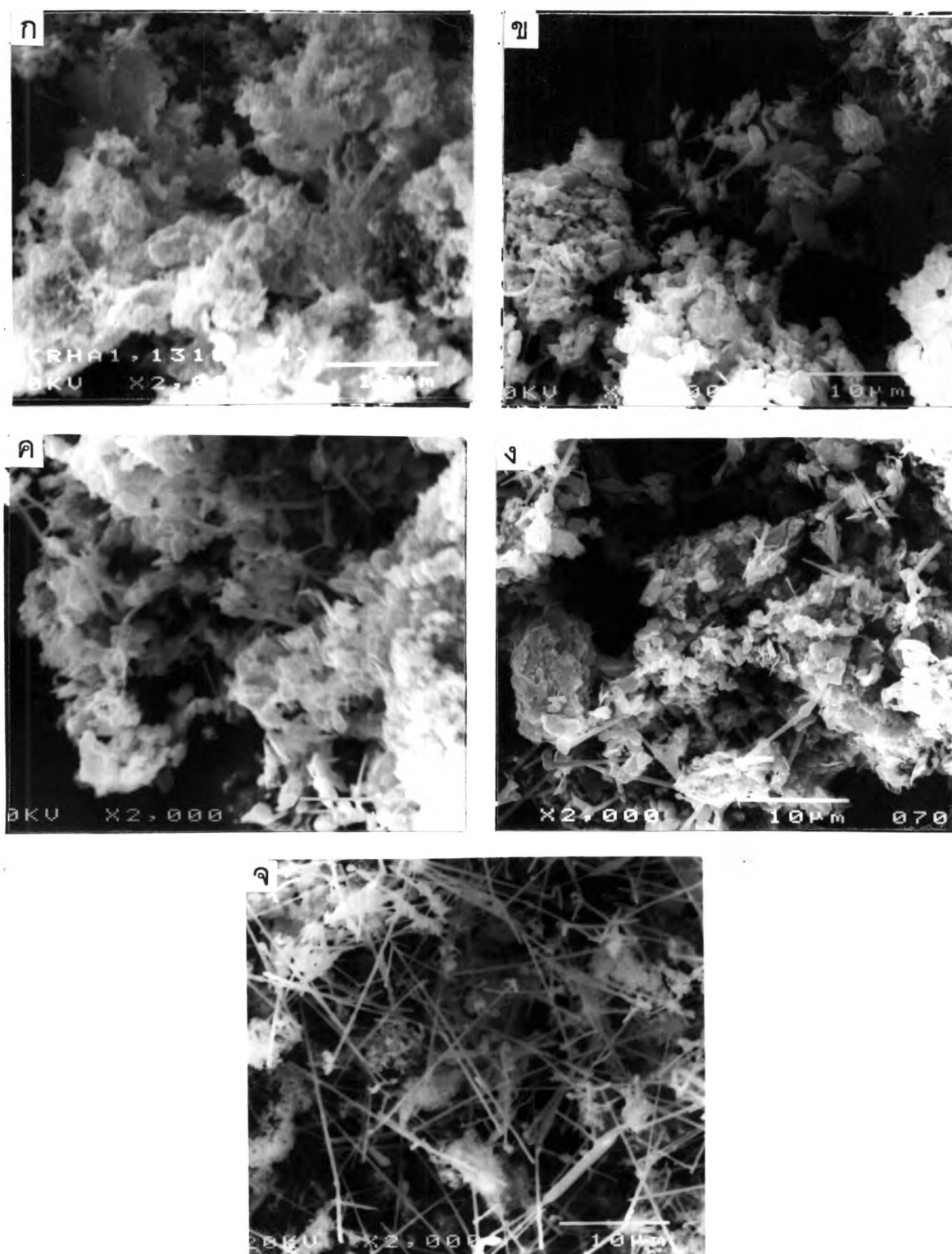
ลักษณะจุลโครงสร้างของ SiC ที่ได้จากการเผา RHA₁ โดยใช้สภาวะการเผาด้วยอัตราให้ความร้อนเร็ว 50 °C ต่อนาที และใช้ soaking time 1 ชั่วโมง ดังรูปที่ 4.14 พบว่าการเผาที่อุณหภูมิต่ำกว่า คือ 1310°C จะปรากฏลักษณะของ SiC วิสเกอร์สที่เป็นไฟเบอร์ ปะปนอยู่กับอนุภาคนาขนาดเล็ก ซึ่งวิสเกอร์สที่ได้มีปริมาณเล็กน้อย คือ ประมาณ 4% โดยวิธี image analysis ส่วนอนุภาคที่เหลือนั้น บางส่วนจะเป็น crystalline particle SiC และส่วนใหญ่จะเป็น SiO₂ และคาร์บอนผลที่ได้จากการศึกษาโดย X-ray diffractometry เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผา จะพบว่า ปริมาณวิสเกอร์สดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น โดยในช่วงแรกปริมาณการเพิ่มจะเป็นไปอย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิ 1610°C ยังปรากฏจุลโครงสร้างของวิสเกอร์อยู่เพียง 15% แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาเป็น 1750°C ในช่วงนี้ การเกิดวิสเกอร์ส เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งพบว่า สารที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิ 1750°C มีปริมาณวิสเกอร์สถึง 75% นอกจากนี้ยังพบว่าที่อุณหภูมิสูงวิสเกอร์สที่ได้มีขนาดยาวต่อเนื่องกันเป็นส่วนใหญ่ โดยไฟเบอร์ที่เกิดขึ้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.03 ไมครอน แสดงว่าวิสเกอร์สดังกล่าวมีลักษณะเป็นเส้นใยผลึกเดี่ยวของแต่ละอะตอมต่อเนื่องกัน ผลการทดลองนี้ได้ผลที่แตกต่างจากผลการทดลองของผู้วิจัยอื่นที่ได้วิสเกอร์ที่อุณหภูมิสูง ในขณะที่ผลงานบางผลงานได้วิสเกอร์ที่อุณหภูมิต่ำแต่บรรยากาศที่ใช้ในการเผานั้นแตกต่างกัน คือการใช้บรรยากาศอาร์กอนในการทดลองนี้ ขณะที่การวิจัยอื่นได้ทำการทดลองในสุญญากาศ ซึ่งแสดงว่า อิทธิพลของบรรยากาศจะเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งของการเกิดปฏิกิริยา

สำหรับลักษณะจุลโครงสร้างของซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการเผา RHA₂ และ RHA₃ จากแหล่งนครราชสีมา และชัยภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 4.16 และ 4.18 นั้นแสดงผลที่คล้ายคลึงกับการใช้ RHA₃ คือปริมาณของวิสเกอร์เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของอุณหภูมิ และปริมาณวิสเกอร์ที่ได้จากการเผา โดยใช้สภาวะเดียวกันมีปริมาณไม่แตกต่างกัน

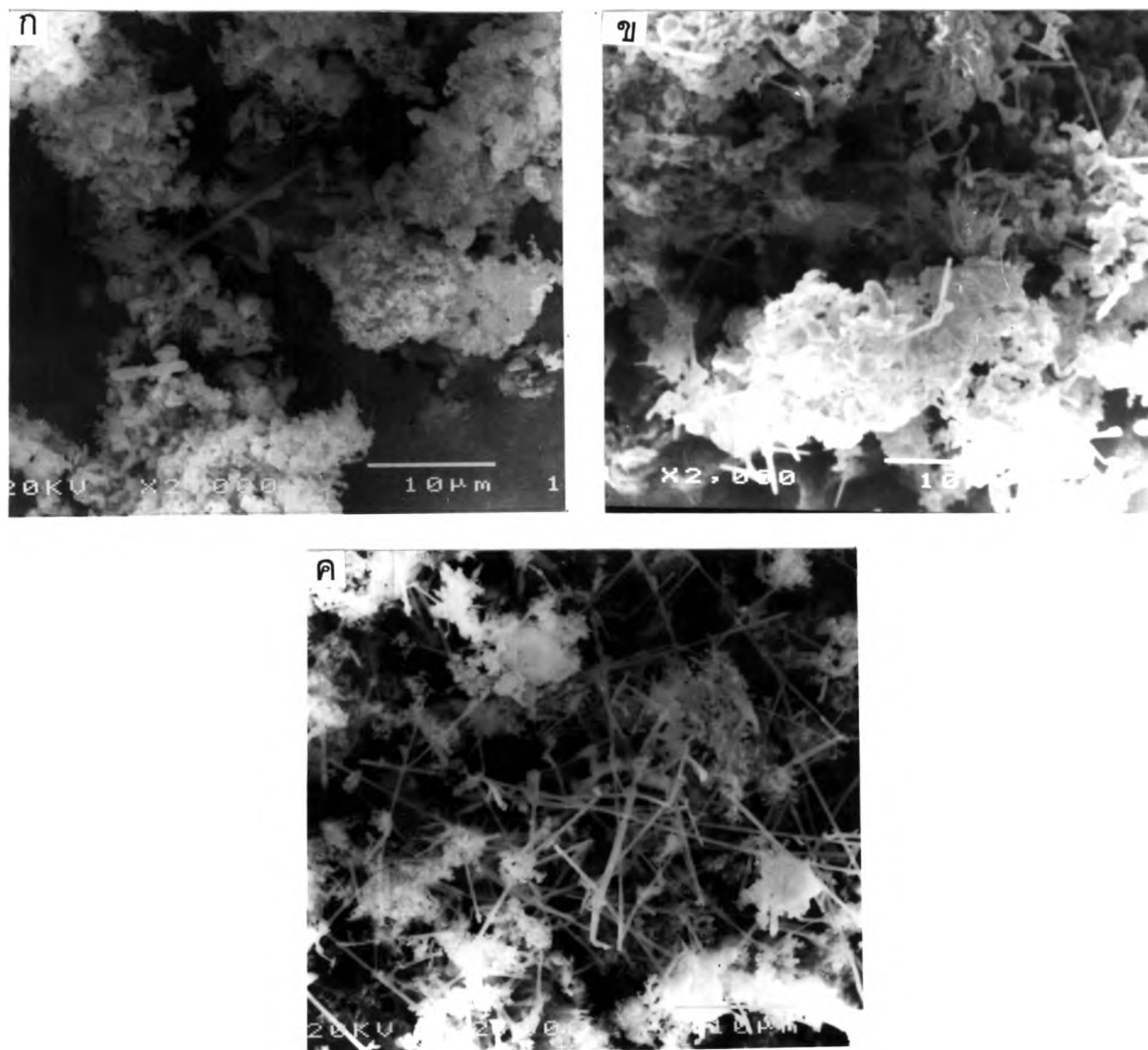
เมื่อเปลี่ยนสภาวะในการเผาโดยการเผาโดยใช้อัตราการให้ความร้อนเท่าเดิม แต่เพิ่มเวลาในการ soak ที่อุณหภูมิสูง เป็น 2 ชั่วโมง ดัง profile ในรูปที่ 3.2 พบว่าการใช้เวลา soak นานขึ้นทำให้วิสเกอร์ที่ได้มีปริมาณน้อยลง เบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ crystalline particle โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิ 1750°C นั้นจะได้ซิลิกอนคาร์ไบด์วิสเกอร์เพียงประมาณ 10% ส่วนที่เหลือเป็น crystalline particle ของซิลิกอนคาร์บอน ตามผลที่ปรากฏตามการวิเคราะห์โดย X-ray diffractometer แต่การเพิ่มปริมาณวิสเกอร์ตามการเพิ่มอุณหภูมิในการเผายังปรากฏอยู่เช่นเดียวกับการเผาโดยใช้ soaking time ระยะสั้น และพบว่าเมื่อเปลี่ยนสภาวะในการเผาโดยให้อัตราการให้ความร้อนช้าลง คือประมาณ 10°C/นาที่ และใช้ soaking time 1 ชั่วโมง ปรากฏว่าการเกิดวิสเกอร์ของซิลิกอนคาร์บอนก็ลดลงด้วย ตามรูปที่ 4.21 และเมื่อให้อัตราการให้ความร้อนช้าและเพิ่ม soaking time เป็น 2 ชั่วโมง ตามจุดโครงสร้างในรูปที่ 4.22 จะเห็นว่าปริมาณวิสเกอร์ลดลงเหลือเพียงประมาณ 5% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยที่ขนาดของวิสเกอร์ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อให้อัตราการให้ความร้อนช้าและ soaking time ระยะยาว แสดงว่าการควบคุมกระบวนการเผาเพื่อให้เกิดวิสเกอร์ซิลิกอนคาร์ไบด์หรือ crystalline particle ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือผสมกัน โดยการควบคุมสภาวะการเผานั้นสามารถทำได้ รวมทั้งการควบคุมให้ได้ขนาดอนุภาคที่ต้องการ สำหรับในการวิจัยนี้จะพบว่าอนุภาคของสารที่ผลิตได้มีขนาดละเอียดมาก ประมาณ 1 μm และ submicron ซึ่งนับว่าเป็นขนาดอนุภาคที่เหมาะสมในการนี้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้ไปผลิตชิ้นงานทางด้านวิศวกรรมต่อไป

ลักษณะจุดโครงสร้างของซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการเผาถ่านแกลบ RHC₁, RHC₂ และ RHC₃ ดังแสดงในรูปที่ 4.15 4.17 และ 4.19 พบว่าที่อุณหภูมิต่ำจะปรากฏวิสเกอร์ของซิลิกอนคาร์ไบด์อยู่เพียง 1-2% ส่วนปริมาณของ crystalline Particle ซิลิกอนคาร์ไบด์นั้นไม่ชัดเจน เนื่องจากผลการวิเคราะห์โดย XRD แสดงพีคของเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ เท่านั้นไม่สามารถแยกปริมาณวิสเกอร์และ crystalline particle ได้ และได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปริมาณการเกิดซิลิกอนคาร์ไบด์ที่อุณหภูมินี้มีต่ำมาก จาก XRD-Peak ที่ intensity ต่ำ ซึ่งก็นับว่าได้ผลสอดคล้องกันทั้งการวิเคราะห์โดย XRD และ SEM การเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ตามการเพิ่มอุณหภูมิการเผาก็ปรากฏอยู่เช่นเดียวกัน และเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1750°C ก็เห็นว่าจุดโครงสร้างที่ได้ไม่แตกต่างจากการเผาถ่านแกลบ คือมีปริมาณวิสเกอร์อยู่มาก และขนาดของอนุภาคและเฟสของวิสเกอร์ก็มีขนาดละเอียดเช่นเดียวกัน

จากผลการศึกษาจุลโครงสร้างและ XRD ของผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังการเผา pyrolysis สามารถสรุปได้ดังตารางที่ ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ในการเผาที่อุณหภูมิต่ำ 1310^o-1410^o จะมีซิลิกอนคาร์ไบด์เกิดขึ้นบางส่วน แต่ซิลิกาและคาร์บอนส่วนใหญ่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาเป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนรูปของซิลิกาอสัณฐานที่เหลืออยู่เป็นผลึกซิลิกาและคาร์บอนเกิดการ form เป็นกราฟไฟต์และคาร์บอนรูปอื่นบางส่วน สำหรับการเผาที่อุณหภูมิสูงระหว่าง 1550^o-1750^o C นั้น ปฏิกิริยาการเกิดซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ โดยที่เกิดส่วนผสมระหว่างซิลิกอนคาร์ไบด์วิสเกอร์และ polycrystal



รูปที่ 4.14 ลักษณะจุดโครงสร้าง ของซิติคอนคาร์ไบด์จากการเผา RHA₁, rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.
 ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C
 ข). ที่อุณหภูมิ 1410°C
 ค). ที่อุณหภูมิ 1550°C
 ง). ที่อุณหภูมิ 1610°C
 จ). ที่อุณหภูมิ 1750°C



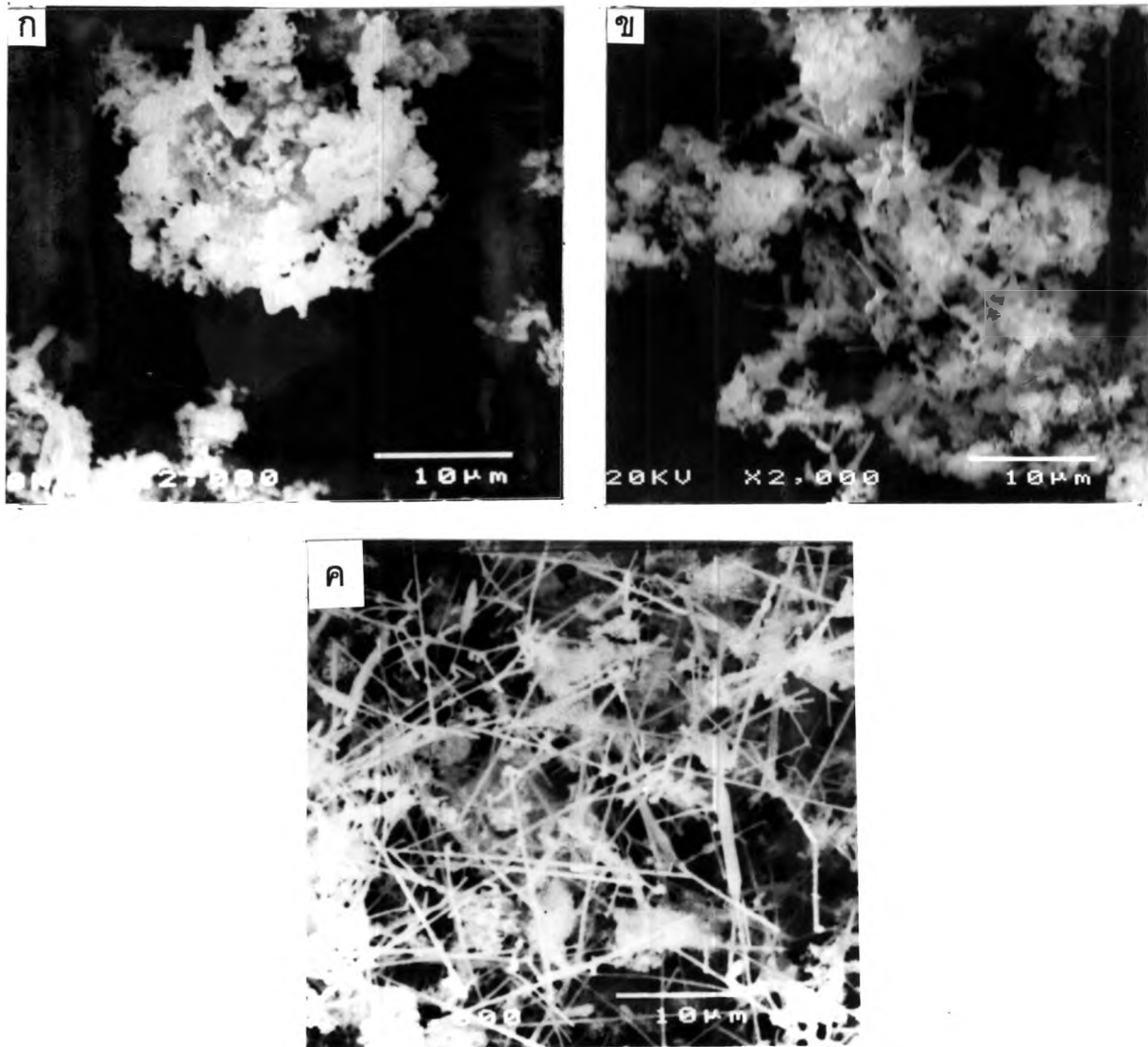
รูปที่ 4.15 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของซิลิกอนคาร์ไบด์จากการเผา RHC₁.

rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.

ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C

ข). ที่อุณหภูมิ 1550°C

ค). ที่อุณหภูมิ 1750°C



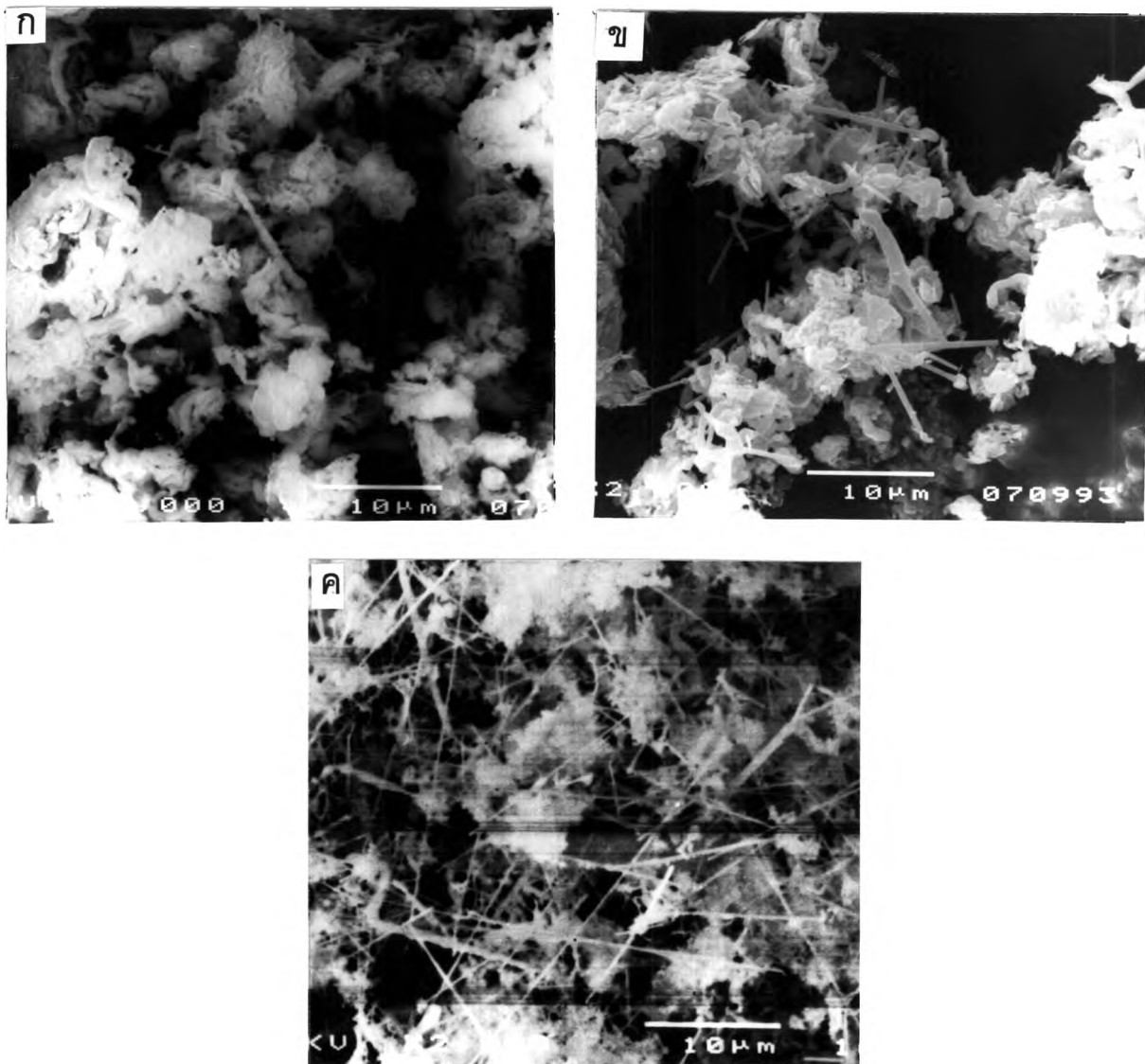
รูปที่ 4.16 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของซิติคอนคาร์ไบด์จากการเผา RHA₂,

rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.

ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C

ข). ที่อุณหภูมิ 1550°C

ค). ที่อุณหภูมิ 1750°C



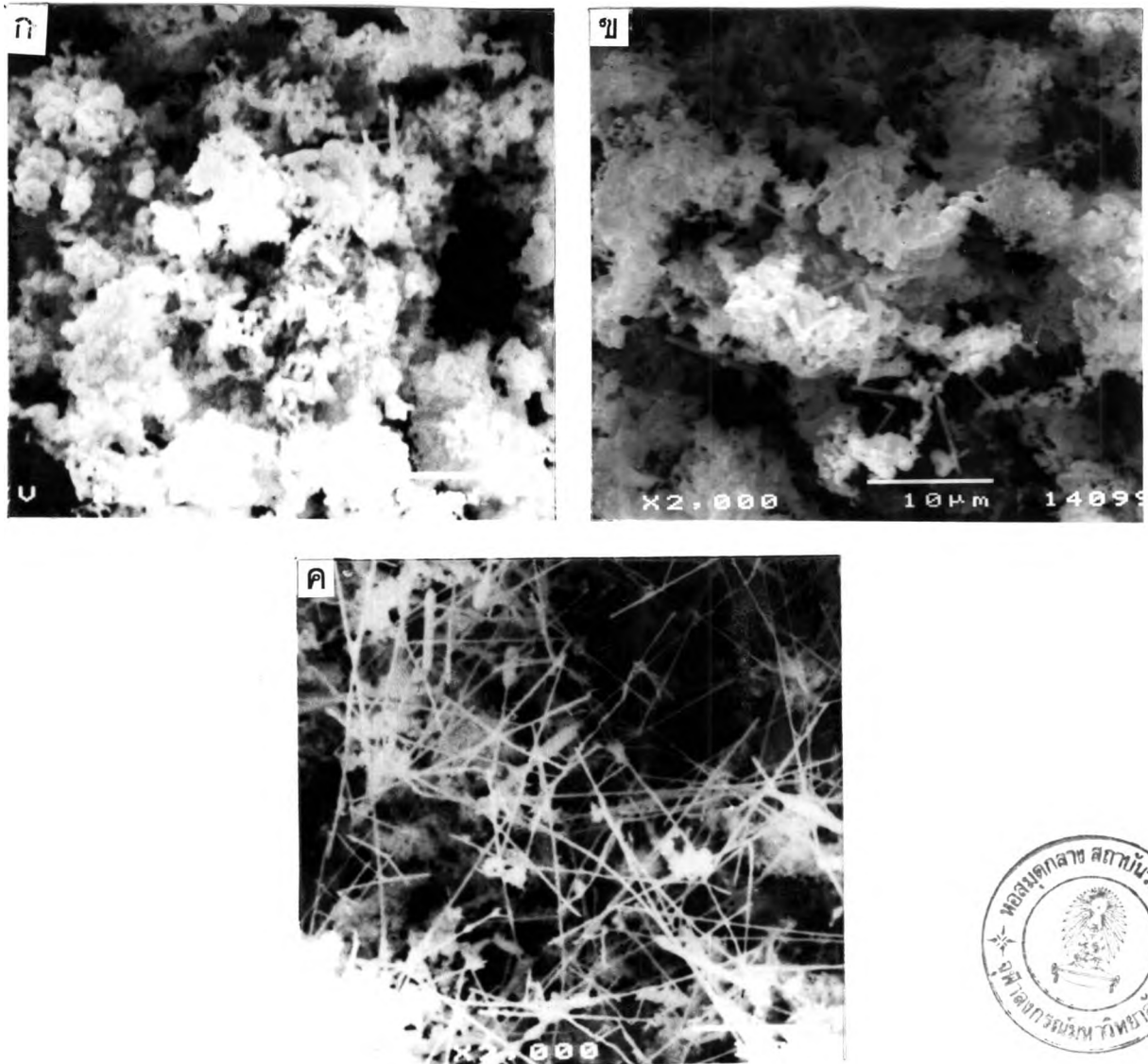
รูปที่ 4.17 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของซิลิกอนคาร์ไบด์จากการเผา RHC₂.

rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.

ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C

ข). ที่อุณหภูมิ 1550°C

ค). ที่อุณหภูมิ 1750°C



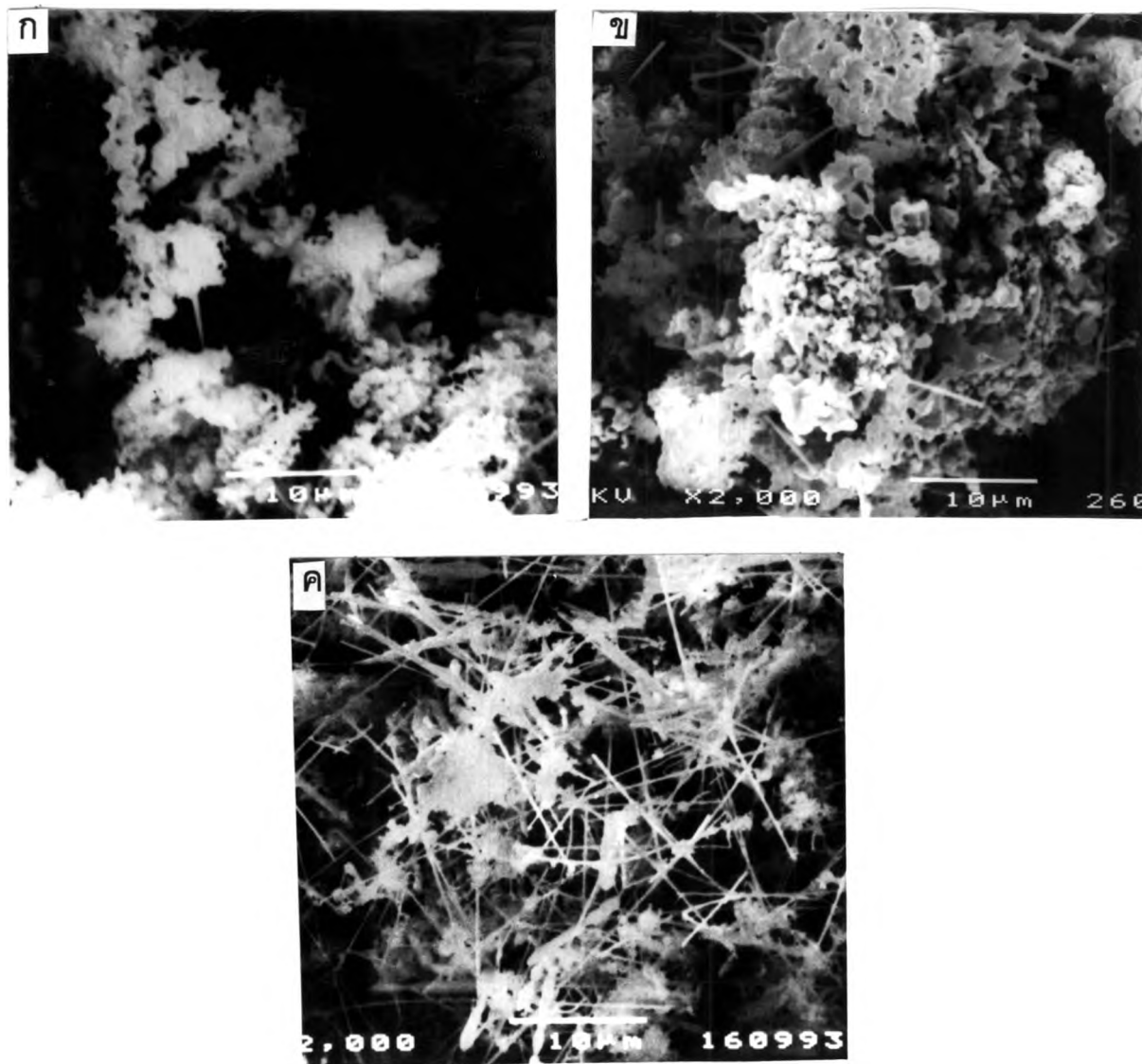
รูปที่ 4.18 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของชิติกอนคาร์ไบด์จากการเผา RHA₃.

rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.

ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C

ข). ที่อุณหภูมิ 1550°C

ค). ที่อุณหภูมิ 1750°C

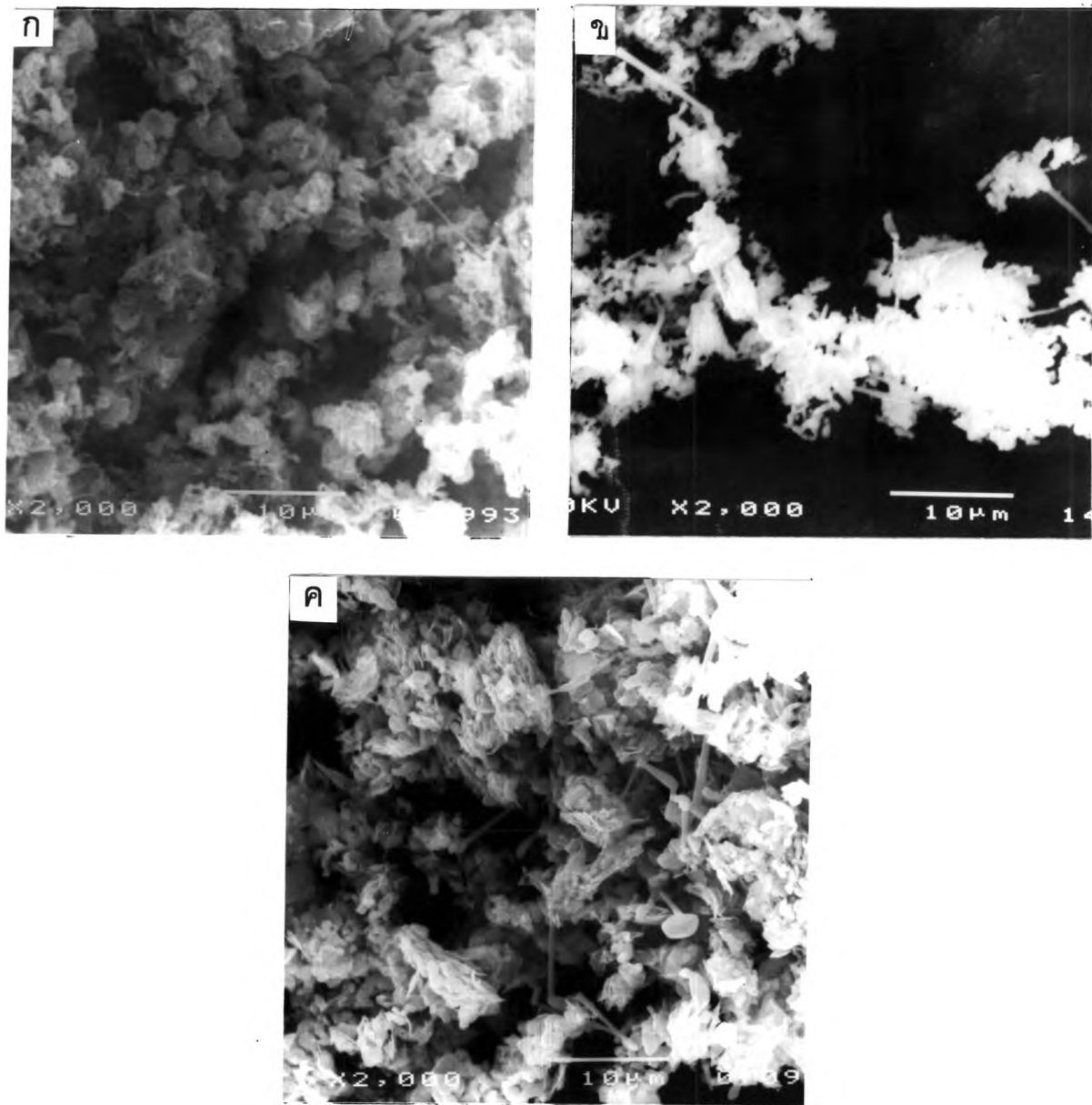


รูปที่ 4.19 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของชิติกอนคาร์ไบด์จากเผา RHC₃,
 rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.
 ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C
 ข). ที่อุณหภูมิ 1550°C
 ค). ที่อุณหภูมิ 1750°C

4.2.4 ผลของการศึกษาอิทธิพลของตัวแปร (parameters)

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ที่ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ, เวลา, และ อัตราในการให้ความร้อน ในการเผาไพโรไลซิสโดยใช้ profile ต่างๆ กัน ดังรูปที่ 3.2 พบว่า ขนาดของทั้งวิสเกอร์และอนุภาคควิกของเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์และปริมาณของวิสเกอร์ เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มอุณหภูมิ แสดงดังรูปที่ 4.20 - 4.22 และเมื่อให้อุณหภูมิการเผาไพโรไลซิสคงที่จะพบว่า การเผาด้วยอัตราการให้ความร้อนช้าและใช้เวลา soak นาน จะทำให้ปริมาณของวิสเกอร์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าการใช้อัตราการให้ความร้อนเร็วและเวลา soak น้อยแสดงดังรูปที่ 4.23 - 4.25 เนื่องจากในแคลบมีโครงสร้างที่เป็นเส้นใย ซึ่งทำหน้าที่เป็นสับสเตรทและนิวคลีไอส์สำหรับการ growth ของซิลิกอนคาร์ไบด์วิสเกอร์ให้เป็นเส้นต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อได้รับความร้อนเป็นเวลานานๆ โครงสร้างที่เป็นเส้นใยนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และเนื่องจากปริมาณของโครงสร้างสับสเตรทเหล่านี้มีอยู่จำกัดในแคลบทำให้ซิลิกาและคาร์บอนอิสระไม่สามารถสัมผัสกับสับสเตรทได้ดี ดังนั้นการเกิดวิสเกอร์จึงมีปริมาณที่จำกัด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ M. Patel and P. Prasonna (1990)

การ soak นานๆ ทำให้ได้ผลึก (crystalline aprticle) ดังนั้นปริมาณวิสเกอร์จึงลดลง และมีผลให้ขนาดของทั้งวิสเกอร์และอนุภาคควิกของเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์เกิด grain growth



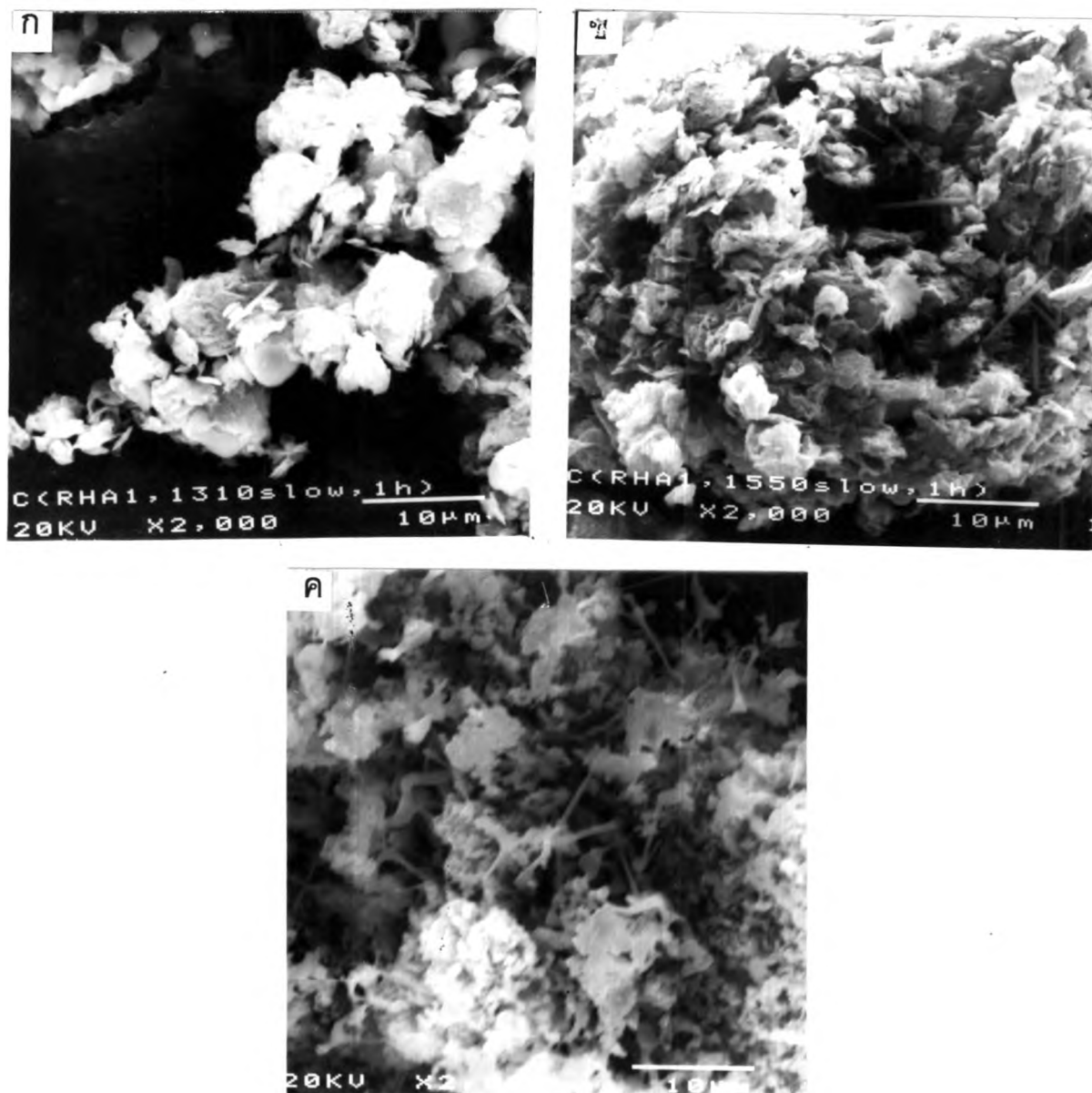
รูปที่ 4.20 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของซีตริกอนคาร์ไบด์จากการเผา RHA₁,

rate 50°C/นาที, soak 2 ชม.

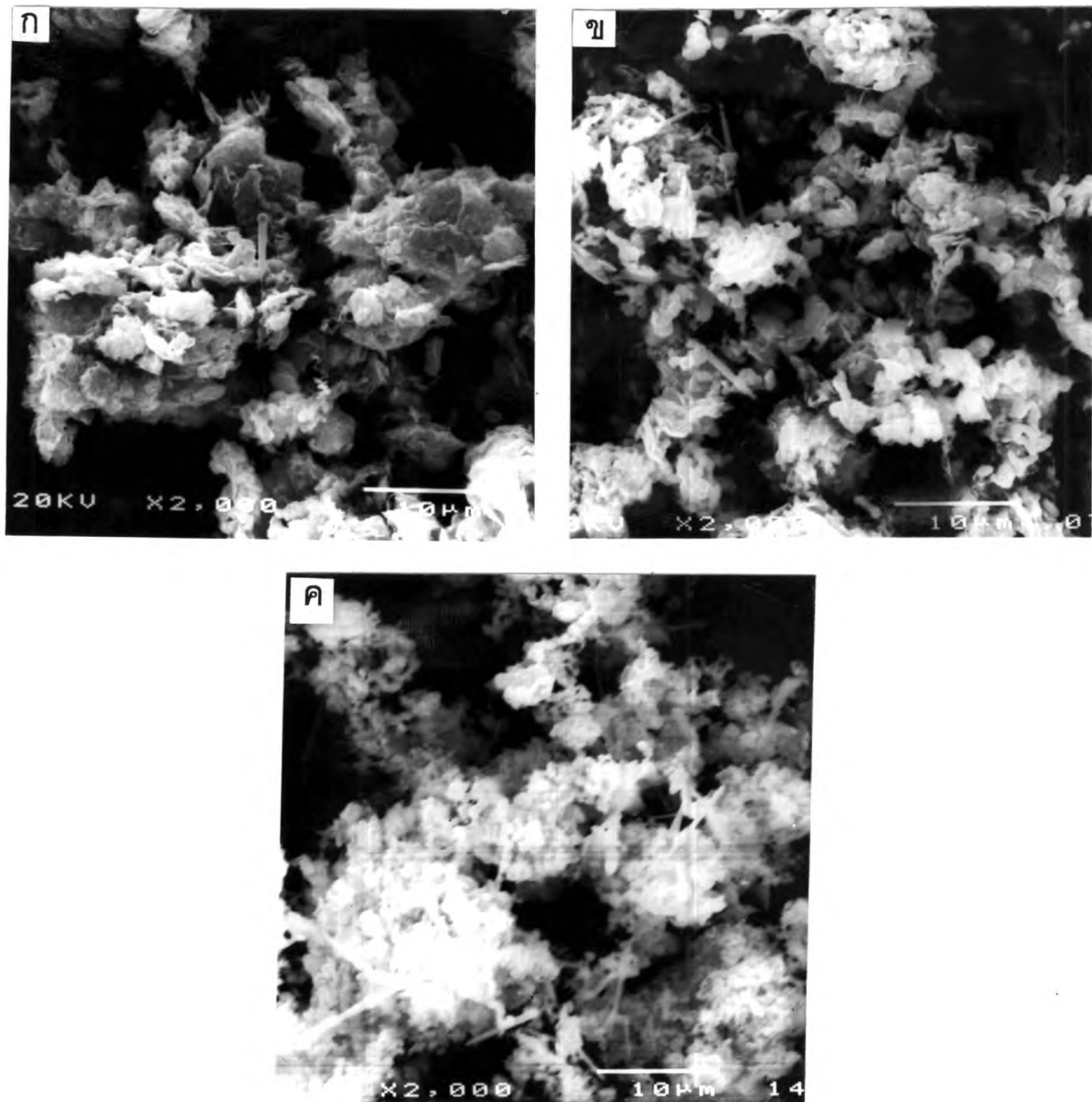
ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C

ข). ที่อุณหภูมิ 1550°C

ค). ที่อุณหภูมิ 1750°C



รูปที่ 4.21 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของซิลิกอนคาร์ไบด์จากการเผา RHA₁,
rate 10°C/นาที, soak 1 ชม.
ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C
ข). ที่อุณหภูมิ 1550°C
ค). ที่อุณหภูมิ 1750°C



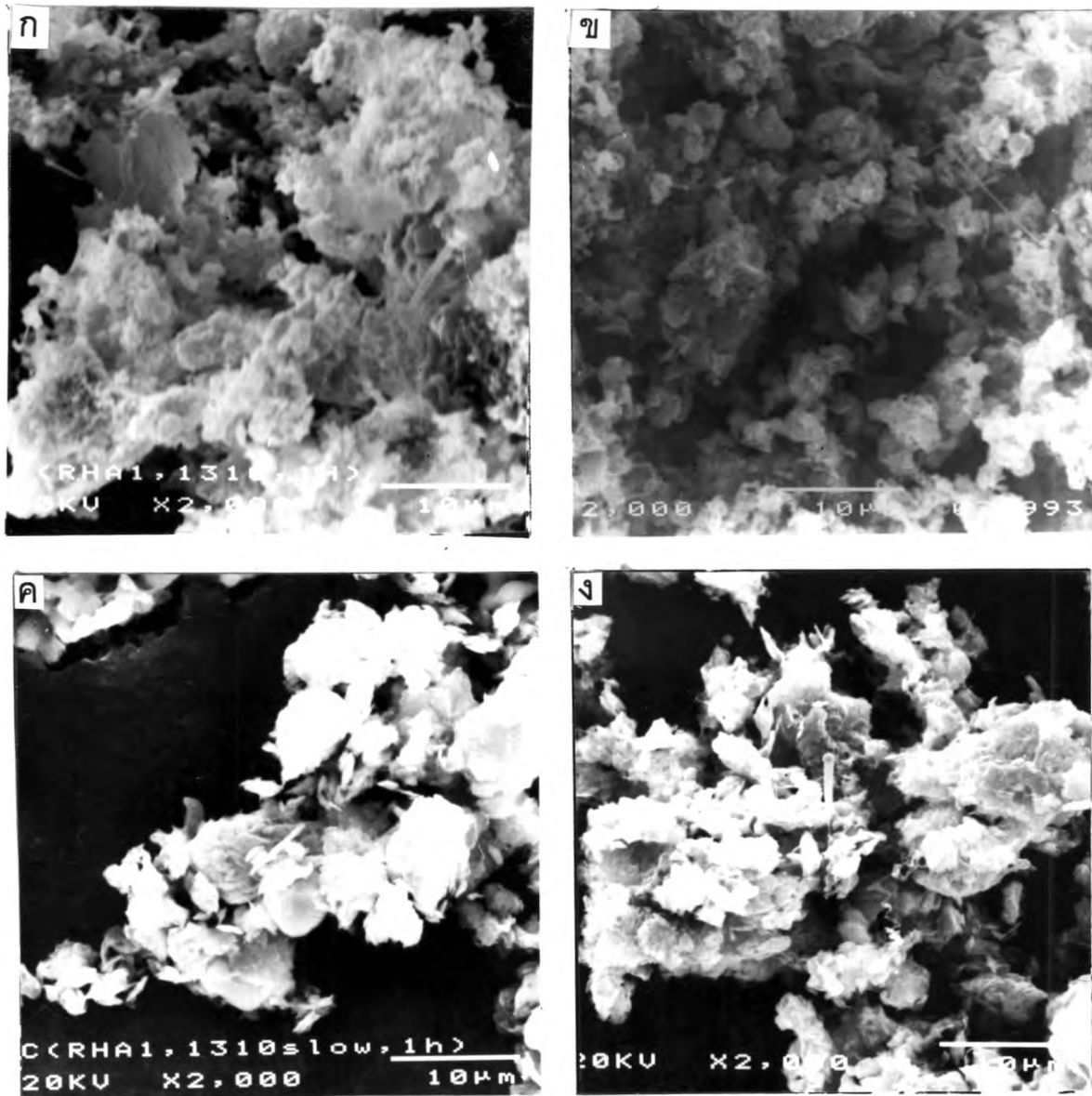
รูปที่ 4.22 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของซิลิกอนคาร์ไบด์จากการเผา RHA₁,

rate 10°C/นาที, soak 2 ชม.

ก). ที่อุณหภูมิ 1310°C

ข). ที่อุณหภูมิ 1550°C

ค). ที่อุณหภูมิ 1750°C



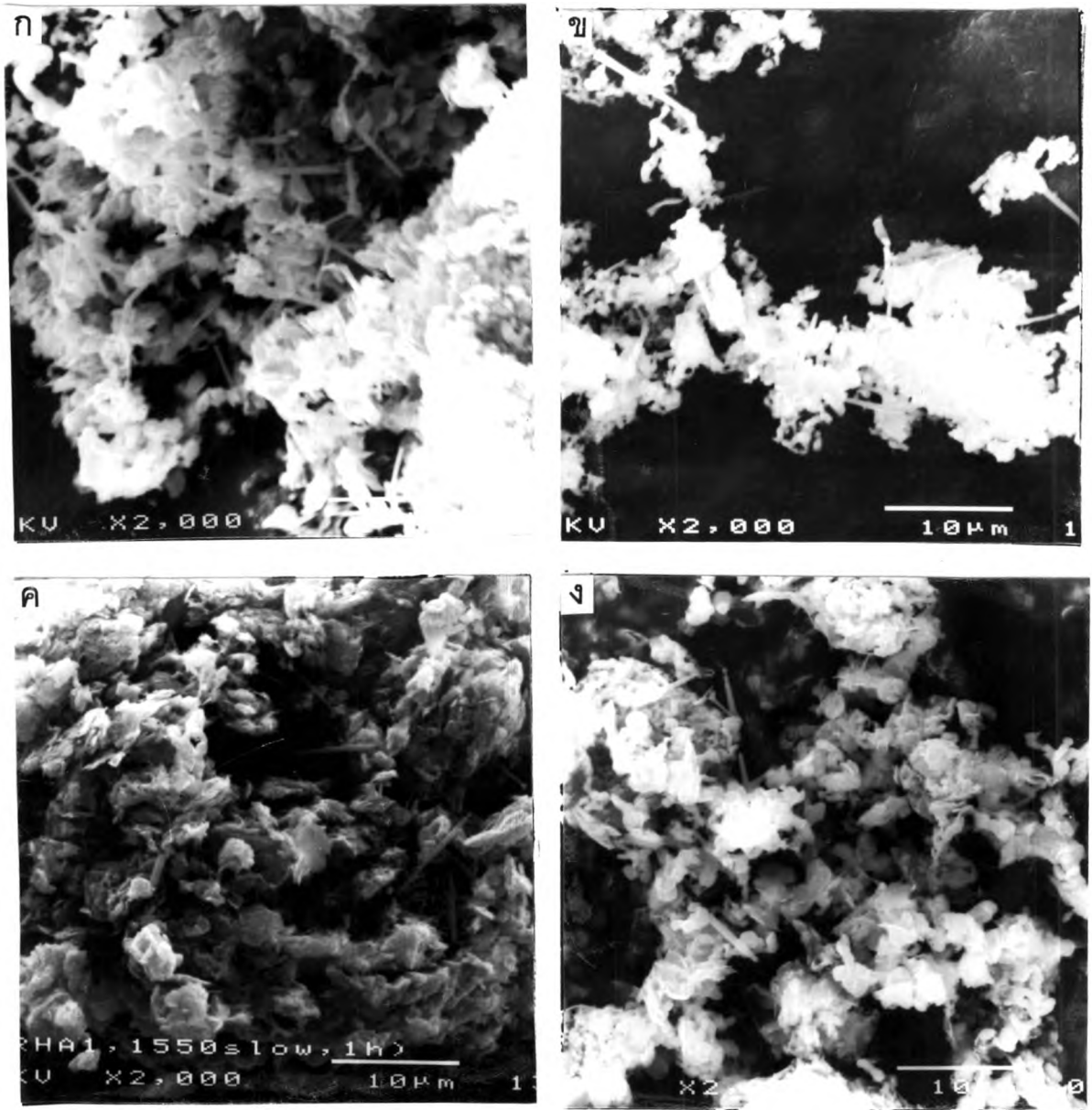
รูปที่ 4.23 ลักษณะรูปร่างโครงสร้าง ของซิติลิกอนคาร์ไบด์จากการเผา RHA₁ ที่ 1310°C

ก). rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.

ค). rate 10°C/นาที, soak 1 ชม.

ข). rate 50°C/นาที, soak 2 ชม.

ง). rate 10°C/นาที, soak 2 ชม.



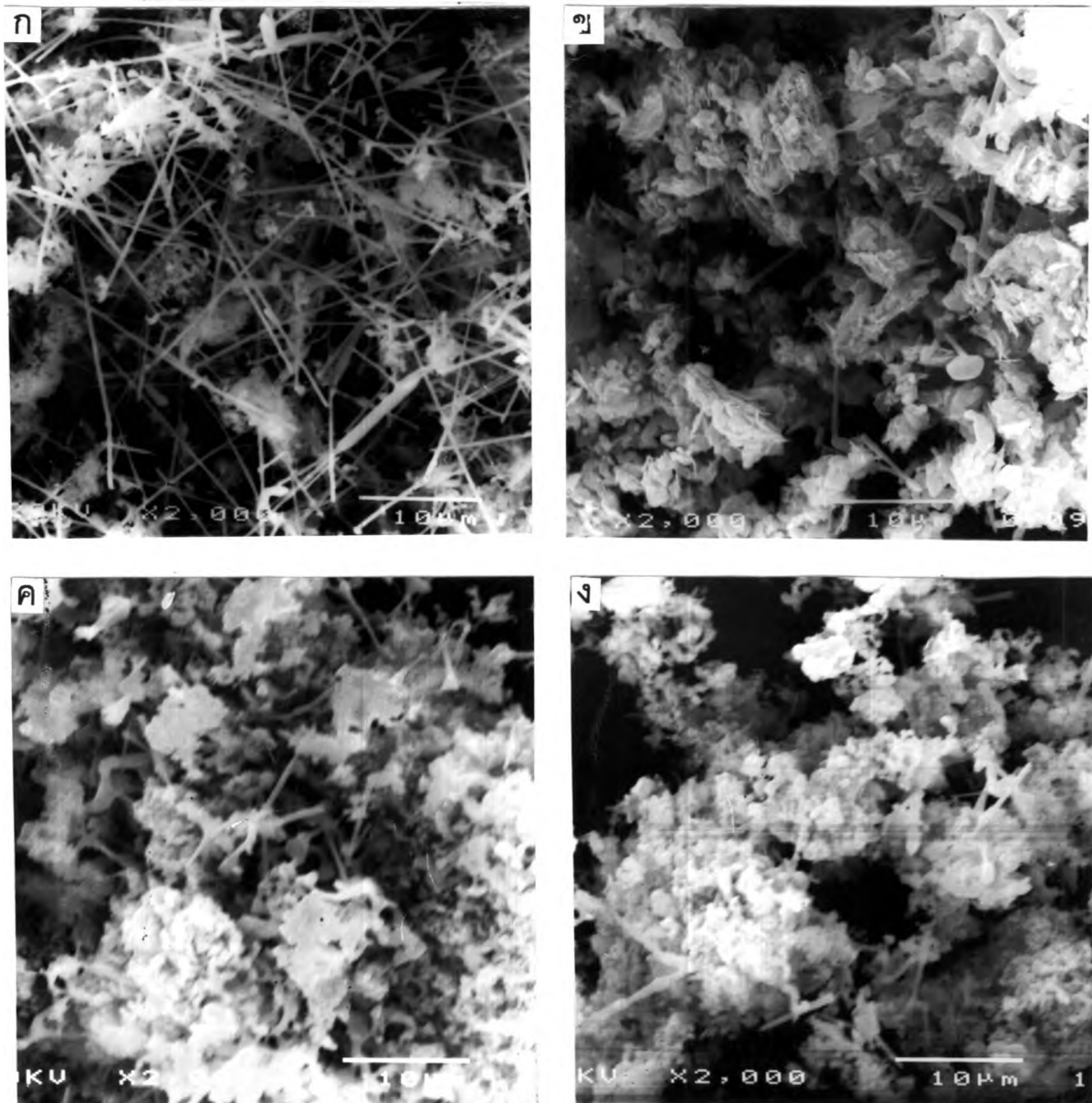
รูปที่ 4.24 ลักษณะรูปร่างโครงสร้าง ของซิลิกา-คาร์บอนไฟเบอร์จากการเผา RHA₁ ที่ 1550°C

ก). rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.

ค). rate 10°C/นาที, soak 1 ชม.

ข). rate 50°C/นาที, soak 2 ชม.

ง). rate 10°C/นาที, soak 2 ชม.



รูปที่ 4.25 ลักษณะจุลโครงสร้าง ของชิตินคาร์ไบด์จากการเผา RHA₁ ที่ 1750°C

ก). rate 50°C/นาที, soak 1 ชม.

ค). rate 10°C/นาที, soak 1 ชม.

ข). rate 50°C/นาที, soak 2 ชม.

ง). rate 10°C/นาที, soak 2 ชม.